Patent Assignee: JSR CORP (JAPS)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind JP 2002020688 A 20020123 JP 2000205945 A 20000706 200243 B

Priority Applications (No Type Date): JP 2000205945 A 20000706

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 2002020688 A 23 C09D-183/04

Abstract (Basic): JP 2002020688 A

NOVELTY - A novel manufacturing method (M1) of membrane forming compositions comprises a process where at least one kind of silane compound (A) is hydrolyzed in the presence of a certain nitrogen onlym salt type compound (B).

DETAILED DESCRIPTION - A novel manufacturing method (M1) of membrane forming compositions comprises a process where at least one kind of silane compound (A) is hydrolyzed in the presence of a certain nitrogen onium salt type compound (B). (A) is selected from the group of silane compounds of formula (1), (2), and (3).

R=H or fluorine atom or univalent organic group;

kekka. TXT

R1=univalent organic group;

R2=univalent organic group;

R3-R6=univalent organic group;

b and c=0-2;

R7=0 or phenylene or -(CH2)n-group;

n = 1 - 6:

d=0 or 1.

INDEPENDENT CLAIMS are also included for:

- (1) a membrane forming composition (P1) that is manufactured by means of (M1). Also claimed is a novel manufacturing method of the membrane (M2) where (P1) is coated on the surface of a substrate and then is heated; and
- (2) a novel siliceous membrane (P2) that is obtained by means of (M2).

USE - (M1) is suitable for manufacture of (P1). (P1) and (M2) are suitable for forming interlayer insulating membranes in semiconductor elements, particularly (P2).

ADVANTAGE - (P1) and (M2) can form (P2) that is excellent in mechanical strength and insulation properties, has a specific permittivity value only slightly dependent on temperature, and hardly causes the change of specific permittivity even after the pressure cooker test.

pp; 23 DwgNo 0/0

Title Terms: MANUFACTURE; METHOD; MEMBRANE; FORMING; COMPOSITION;

INTERLAYER; INSULATE; MEMBRANE; SEMICONDUCTOR; ELEMENT; ONE; KIND; SILANE

; COMPOUND; HYDROLYSIS; PRESENCE; NITROGEN; ONIUM; SALT

Derwent Class: A26; A85; E11; G02; L03; U11

International Patent Class (Main): CO9D-183/04

International Patent Class (Additional): C09D-183/02: C09D-183/14

File Segment: CPI; EPI

$\rightarrow 1/5/2$

DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

Image available 014313113 WPI Acc No: 2002-133815/200218

XRAM Acc No: C02-041.195

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号。

特開2002-20688

(P2002-20688A)

(43)公開日 平成14年1月23日(2002.1.23)

(51) Int. Cl. CO9D183/04	識別記号	F I CO9D183/04 183/02	デーマコート'(変 4J038	参考)
183/14	•	183/14	•	

審査請求 未請求 請求項の数11 〇L (全23頁)

(21)出願番号	特願2000-205945(P2000-205945)	(71)出願人	000004178
•	•	1	ジェイエスアール株式会社
(22)出願日	平成12年7月6日(2000.7.6)		東京都中央区築地2丁目11番24号
		(72)発明者	林 英治
,	•		東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエ
			スアール株式会社内
	·	(72)発明者	西川 通則
	•		東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエ
			スアール株式会社内
		(72)発明者	山田 欣司
			東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエ
			スアール株式会社内
•			
	,	İ	最終頁に続く

(54) 【発明の名称】膜形成用組成物の製造方法、膜形成用組成物、膜の形成方法およびシリカ系膜

(57)【要約】 (修正有)

半導体素子などにおける層間絶縁膜材料と して、塗膜の比誘電率の温度依存性が小さく、PCT (Pressure Cooker Test) 後の比誘電率変化が少なく、 かつ塗膜の機械的強度に優れたシリカ系膜が形成可能な・ 膜形成用組成物を得る。

【解決手段】 (A) 下記一般式(1)、(2)、

(3) で表される化合物の群から選ばれた少なくとも1 種の化合物を、(B)窒素オニウム塩化合物の存在化で 加水分解する事を特徴とする膜形成用組成物の製造方 法。

 R_{\bullet} (Si) (OR¹) \leftarrow ····· (1)

 $Si(OR^2)_{\bullet} \cdots (2)$

 $R^{3}_{b}(R^{4}0)_{3-b}$ Si- $(R^{7})_{d}$ -Si $(0R^{5})_{3-c}$ R^{6}_{c}(3)

(式中Rは水素原子、フッ素原子、又は一価の有機基、 R¹~R゚は一価の有機基、R'は酸素原子、フェニレ ン基又は- (CH₂) _n - 、aは1~2の整数、b、c は0~2の数、dは0又は1、nは1~6の整数を示 す。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 下記一般式(1) で表される化 合物、下記一般式(2)で表される化合物および下記一 般式(3)で表される化合物の群から選ばれた少なくと も1種のシラン化合物を、

$$R^{3}_{b}$$
 $(R^{6}O)_{3b}$ $Si - (R^{7})_{a} - Si$ $(OR^{5})_{3c}$ R^{6} , · · · (3)

〔式中、 $R^3 \sim R^6$ は同一または異なり、それぞれ1価 の有機基、bおよびcは同一または異なり、0~2の数 を示し、R'は酸素原子、フェニレン基または-(CH 2)。一で表される基(ここで、nは1~6の整数であ 10 載の膜形成用組成物の製造方法。 る)、dは0または1を示す。〕

(B) 窒素オニウム塩化合物の存在下で加水分解するこ とを特徴とする膜形成用組成物の製造方法。

(B) 窒素オニウム塩化合物が (B-【請求項2】 (R*R*R*R** N) . R** R" (R"),

(式中、R[®]~R"は同一または異なり、それぞれ水素 原子、炭素数1~10のアルキル基、ヒドロキシアルキ ル基、アリール基、アリールアルキル基を示し、R"は ハロゲン原子、1~4価のアニオン性基を示し、eは1 ~4の整数を示し、R"は窒素原子を含有するg価の環 状カチオン性基を示し、R"はハロゲン原子、f 価のア ニオン性基を示し、fは1~4の整数、gは1~fの整 数を示し、g・h≤fである。)

【請求項4】 (B) 成分の使用量が、(A) 成分中の アルコキシル基の総量1モルに対して0.0001~ 1モルであることを特徴とする請求項1記載の膜形成用 組成物。

【請求項5】 加水分解時の(A)成分の濃度が0.5 ~10重量%(完全加水分解縮合物換算)であることを 30 R¹⁵ O (CHCH, CH₂O), R¹⁶

(R"およびR"は、それぞれ独立して水素原子、炭素 数1~4のアルキル基またはCH,CO-から選ばれる 1価の有機基を示し、gは1~2の整数を表す。)

【請求項10】 請求項8項記載の膜形成用組成物を基 板に塗布し、加熱することを特徴とする膜の形成方法。

【請求項11】 請求項10記載の膜の形成方法によって 得られるシリカ系膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、膜形成用組成物の 製造法とそれを用いた膜形成用組成物に関し、さらに詳 しくは、半導体素子などにおける層間絶縁膜材料とし essure Cooker Test) 後の比誘電率変化が少なく、かつ 塗膜の機械的強度に優れたシリカ系膜が形成可能な膜形 成用組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁 膜として、CVD法などの真空プロセスで形成されたシ 50 をアンモニアの存在下縮合することにより得られた塗布

R. S i (OR1) +- \cdots (1)

(式中、Rは水素原子、フッ素原子または1価の有機 基、R'は1価の有機基、aは1~2の整数を示す。) Si (OR2) $\cdots (2)$

(式中、R² は1価の有機基を示す。)

1) 窒素含有化合物と(B-2) アニオン性基含有化合 物およびハロゲン化合物から選ばれる少なくとも1種と から形成されるものであることを特徴とする請求項1記

【請求項3】(B)成分が、下記一般式(4)で表され る化合物および(5)で表される化合物から選ばれる少 なくとも1種であることを特徴とする請求項1記載の膜 形成用組成物の製造方法。

. (4)

特徴とする請求項1記載の膜形成用組成物の製造方法。 【請求項6】 さらに(C)水および(D)沸点100 ℃以下のアルコールの存在下に(A)成分を加水分解す。 20 ることを特徴とする請求項1記載の膜形成用組成物の製 造方法。

【請求項7】 (C)水の使用量が、(A)成分1モル に対して0.5~150モルであることを特徴とする請 求項1記載の膜形成用組成物の製造方法。

【請求項8】 請求項1~6記載の製造方法で得られる 膜形成用組成物。

(E) 下記一般式(6) で表される溶剤 【請求項9】 を含有することを特徴とする請求項7記載の膜形成用組 成物。

 $\cdots (6)$

リカ(SiO.)膜が多用されている。そして、近年、 より均一な層間絶縁膜を形成することを目的として、S OG (Spin on Glass) 膜と呼ばれるテト ラアルコキシランの加水分解生成物を主成分とする塗布 型の絶縁膜も使用されるようになっている。また、半導 体素子などの高集積化に伴い、有機SOGと呼ばれるポ リオルガノシロキサンを主成分とする低比誘電率の層間 絶縁膜が開発されている。特に半導体素子などのさらな 40 る高集積化や多層化に伴い、より優れた導体間の電気絶 ·縁性が要求されており、したがって、途膜の比誘電率の 温度依存性が小さく、PCT後の比誘電率変化が少な く、かつ途膜の機械的強度に優れた層間絶縁膜材料が求 められるようになっている。

【0003】低比誘電率の材料としては、アンモニアの 存在下にアルコキシシランを縮合して得られる微粒子と アルコキシシランの塩基性部分加水分解物との混合物か らなる組成物(特開平5-263045、同5-315 319)や、ポリアルコキシシランの塩基性加水分解物

液(特開平11-340219、同11-34022 0)が提案されているが、これらの方法で得られる材料は、反応の生成物の性質が安定せず、塗膜の比誘電率の温度依存性、PCT後の比誘電率変化、塗膜の機械的強度などの膜特性のバラツキも大きいため、工業的生産には不向きであった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点を解決するための膜形成用組成物に関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶縁膜として、金膜の比誘電率の温度依存性が小さく、PCT後の比誘電率変化が少なく、かつ金膜の機械的強度に優れた膜形成用組成物および該組成物から得られるシリカ系膜を提供する

$$R^{3}$$
, $(R^{4} O)_{34}$ $Si - (R^{7})_{4} - Si (OR^{5})_{34}$ R^{6} , · · · (3)

[式中、 R^3 $\sim R^6$ は同一または異なり、それぞれ1価の有機基、b および c は同一または異なり、 $0\sim 2$ の数を示し、 R^3 は酸素原子、フェニレン基または - (CH c) e 一で表される基(ここで、e は $1\sim 6$ の整数である)、e は0 または 1 を示す。〕

(B) 窒素オニウム塩化合物の存在下で加水分解することを特徴とする膜形成用組成物の製造方法に関する。次に、本発明は、上記製造方法で得られる膜形成用組成物に関する。次に、本発明は、上記膜形成用組成物を基板に塗布し、加熱することを特徴とする膜の形成方法に関する。次に、本発明は、上記膜の形成方法によって得られるシリカ系膜に関する。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明において、(A)成分の加 水分解縮合物とは、上記化合物(1)~(3)の群から 選ばれた少なくとも1種の加水分解物縮合物である。こ こで、(A)成分における加水分解物とは、上記(A) 成分を構成する化合物(1)~(3)に含まれるR'O -基, R² O-基, R⁴ O-基およびR⁶ O-基のすべ てが加水分解されている必要はなく、例えば、1個だけ が加水分解されているもの、2個以上が加水分解されて いるもの、あるいは、これらの混合物であってもよい。 また、(A)成分における縮合物は、(A)成分を構成 する化合物(1)~(3)の加水分解物のシラノール基 が縮合してSi-O-Si結合を形成したものである が、本発明では、シラノール基がすべて縮合している必 要はなく、僅かな一部のシラノール基が縮合したもの、 縮合の程度が異なっているものの混合物などをも包含し た概念である。

【0007】化合物(1);上記一般式(1)において、RおよびR'の1価の有機基としては、アルキル基、アリール基、アリル基、グリシジル基などを挙げることができる。また、一般式(1)において、Rは1価の有機基、特にアルキル基またはフェニル基であることが好ましい。ここで、アルキル基としては、メチル基、

ことを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)下記一般式(1)で表される化合物(以下、「化合物1」ともいう)、下記一般式(2)で表される化合物(以下、「化合物2」ともいう)および下記一般式(3)(以下、「化合物3」ともいう)で表される化合物の群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物をR.Si(OR')。・・・・・(1)(式中、Rは水素原子、フッ素原子または1価の有機基、R'は1価の有機基、aは1~2の整数を示す。)Si(OR')。・・・・・(2)(式中、R'は1価の有機基を示す。)

エチル基、プロピル基、ブチル基などが挙げられ、好ましくは炭素数1~5であり、これらのアルキル基は鎖状でも、分岐していてもよく、さらに水素原子がフッ素原子などに置換されていてもよい。一般式(1)におい

て、アリール基としては、フェニル基、ナフチル基、メ チルフェニル基、エチルフェニル基、クロロフェニル 基、ブロモフェニル基、フルオロフェニル基などを挙げ ることができる。

【0008】一般式(1)で表される化合物の具体例と しては、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、ト リーn-プロポキシシラン、トリーiso-プロポキシ. シラン、トリーnープトキシシラン、トリーsecーブ トキシシラン、トリーtert-プトキシシラン、トリ フェノキシシラン、フルオロトリメトキシシラン、フル 30 オロトリエトキシシラン、フルオロトリーnープロポキ シシラン、フルオロトリーisoープロポキシシラン、 フルオロトリーnープトキシシラン、フルオロトリーs. ecーブトキシシラン、フルオロトリーtertーブト キシシラン、フルオロトリフェノキシシランなど: 【0009】メチルトリメトキシシラン、メチルトリエ トキシシラン、メチルトリーnープロポキシシラン、メ チルトリーiso-プロポキシシラン、メチルトリーn ーブトキシシラン、メチルトリーsecープトキシシラ ン、メチルトリーtertープトキシシラン、メチルト 40 リフェノキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチ ルトリエトキシシラン、エチルトリーnープロポキシシ ラン、エチルトリーisoープロポキシシラン、エチル トリーnープトキシシラン、エチルトリーsecープト キシシラン、エチルトリーtertーブトキシシラン、 エチルトリフェノキシシラン、ビニルトリメトキシシラ ン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリーnープロ ポキシシラン、ビニルトリーiso-プロポキシシラ ン、ビニルトリーnープトキシシラン、ビニルトリーs ecーブトキシシラン、ビニルトリーtertーブトキ 50 シシラン、ビニルトリフェノキシシラン、n-プロピル

トリメトキシシラン、n-プロピルトリエトキシシラ ン、nープロピルトリーnープロポキシシラン、nープ ロピルトリーisoープロポキシシラン、nープロピル トリーnープトキシシラン、nープロピルトリーsec ープトキシシラン、nープロピルトリーtertープト キシシラン、nープロピルトリフェノキシシラン、iー プロピルトリメトキシシラン、iープロピルトリエトキ シシラン、iープロピルトリーnープロポキシシラン、 i-プロピルトリーiso-プロポキシシラン、i-プ secーブトキシシラン、iープロピルトリーtert ープトキシシラン、iープロピルトリフェノキシシラ ン、nープチルトリメトキシシラン、nープチルトリエ トキシシラン、nープチルトリーnープロポキシシラ ン、n-ブチルトリーiso-プロポキシシラン、n-ブチルトリーnーブトキシシラン、nーブチルトリーs ecープトキシシラン、nープチルトリーtertープ トキシシラン、nープチルトリフェノキシシラン、se cーブチルトリメトキシシラン、secーブチルトリエ シラン、secープチルートリーisoープロポキシシ ラン、secーブチルートリーnーブトキシシラン、s e c ープチルートリーsecープトキシシラン、sec ープチルートリーtertープトキシシラン、sec-ブチルートリフェノキシシラン、 t ープチルトリメトキ シシラン、tープチルトリエトキシシラン、tープチル トリーnープロポキシシラン、tーブチルトリーiso -プロポキシシラン、t-ブチルトリ-n-ブトキシシ ラン、tーブチルトリーsecーブトキシシラン、tー ブチルトリーtert-プトキシシラン、t-プチルト リフェノキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フ ェニルトリエトキシシラン、フェニルトリーnープロポ キシシラン、フェニルトリーiso-プロポキシシラ ン、フェニルトリーnープトキシシラン、フェニルトリ -sec-ブトキシシラン、フェニルトリーtert-ブトキシシラン、フェニルトリフェノキシシラン、ビニ ルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、γ -アミノプロピルトリメトキシシラン、γ-アミノプロ ピルトリエトキシシラン、γーグリシドキシプロピルト リメトキシシラン、ァーグリシドキシプロピルトリエト キシシラン、γートリフロロプロピルトリメトキシシラ ン、y-トリフロロプロピルトリエトキシシランなど; 【0010】ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエ トキシシラン、ジメチルージーnープロポキシシラン、 ジメチルージーiso-プロポキシシラン、ジメチルー ジーnーブトキシシラン、ジメチルージーsecープト キシシラン、ジメチルージーtertーブトキシシラ ン、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメトキシ シラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルージーn

5

シシラン、ジエチルージーnープトキシシラン、ジエチ ルージーsecーブトキシシラン、ジエチルージーte rtープトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラン、 ジーnープロピルジメトキシシラン、ジーnープロピル ジエトキシシラン、ジーnープロピルージーnープロポ キシシラン、ジーn-プロピルージーiso-プロポキ シシラン、ジーnープロピルージーnープトキシシラ ン、ジーnープロピルージーsecーブトキシシラン、 ジーnープロピルージーtertーブトキシシラン、ジ ロピルトリーn-ブトキシシラン、i-プロピルトリー 10 -n-プロピルージーフェノキシシラン、ジーiso-プロピルジメトキシシラン、ジーisoープロピルジエ トキシシラン、ジーisoープロピルージーnープロポ キシシラン、ジーisoープロピルージーisoープロ ポキシシラン、ジーiso-プロピルージーn-ブトキ シシラン、ジーisoープロピルージーsecーブトキ シシラン、ジーisoープロピルージーtertープト キシシラン、ジーisoープロピルージーフェノキシシ ラン、ジーnープチルジメトキシシラン、ジーnーブチ ルジエトキシシラン、ジーnープチルージーnープロポ トキシシラン、secーブチルートリーnープロポキシ 20 キシシラン、ジーnーブチルージーisoープロポキシ シラン、ジーnープチルージーnープトキシシラン、ジ -n-ブチルージーsec-ブトキシシラン、ジーn-プチルージーtertーブトキシシラン、ジーnーブチ ルージーフェノキシシラン、ジーsecーブチルジメト キシシラン、ジーsecープチルジエトキシシラン、ジ - s.e c - ブチルージーn - プロポキシシラン、ジーs ecープチルージーisoープロポキシシラン、ジーs ecーブチルージーnープトキシシラン、ジーsecー ブチルージーsecープトキシシラン、ジーsecーブ 30 チルージーtertープトキシシラン、ジーsecーブ チルージーフェノキシシラン、ジーtertープチルジ メトキシシラン、ジーtertーブチルジエトキシシラ ン、ジーtertープチルージーnープロポキシシラ ン、ジーtertーブチルージーisoープロポキシシ ラン、ジーtertープチルージーnープトキシシラ ン、ジーtertープチルージーsecーブトキシシラ ン、ジーtertーブチルージーtertーブトキシシ ラン、ジーtertープチルージーフェノキシシラン、 ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルージーエトキ 40 シシラン、ジフェニルージーnープロポキシシラン、ジ フェニルージーisoープロポキシシラン、ジフェニル ージーn-ブトキシシラン、ジフェニルージーsec-プトキシシラン、ジフェニルージーtertーブトキシ シラン、ジフェニルジフェノキシシラン、ジビニルトリ メトキシシランなど;を挙げることができる。 【0011】化合物(1)として好ましい化合物は、メ

チルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、 メチルトリーnープロポキシシラン、メチルトリーis o-プロポキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エ -プロポキシシラン、ジエチルージーiso-プロポキ 50 チルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、

ビニルトリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラ ン、フェニルトリエトキシシラン、ジメチルジメトキシ シラン、ジメチルジエトキシシラン、ジエチルジメトキ シシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジフェニルジメ トキシシラン、ジフェニルジエトキシシランなどであ る。これらは、1種あるいは2種以上を同時に使用して もよい。

【0012】化合物(2);上記一般式(2)におい て、R² で表される1価の有機基としては、先の一般式 (1) と同様な有機基を挙げることができる。一般式 (2) で表される化合物の具体例としては、テトラメト キシシラン、テトラエトキシシラン、テトラーnープロ ポキシシラン、テトラーiso-プロポキシシラン、テ トラーnーブトキシラン、テトラーsecーブトキシシ ラン、テトラーtertープトキシシラン、テトラフェ ノキシシランなどが挙げられる。

【0013】化合物(3):上記一般式(3)におい て、R³~R⁶で表される1価の有機基としては、先の 一般式(1)と同様な有機基を挙げることができる。一 般式(3)のうち、R'が酸素原子の化合物としては、 ヘキサメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシロキ サン、ヘキサフェノキシジシロキサン、1、1、1、 3, 3-ペンタメトキシー3-メチルジシロキサン、 1, 1, 1, 3, 3ーペンタエトキシー3ーメチルジシ ロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタフェノキシ-3ーメチルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3ーペンタメ トキシー3ーエチルジシロキサン、1,1,1,3,3 -ペンタエトキシ-3-エチルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3ーペンタフェノキシー3ーエチルジシロキサ ン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタメトキシー3-フェニ 30 ることができる。 ルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタエトキシ -3-フェニルジシロキサン、1,1,1,3,3-ペ ` ンタフェノキシー3-フェニルジシロキサン、1,1, 3, 3-テトラメトキシ-1, 3-ジメチルジシロキサ ン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシー1, 3-ジメチ ルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラフェノキシー 1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テト ラメトキシー1, 3ージエチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシ-1, 3-ジエチルジシロキサ ン、1, 1, 3, 3-テトラフェノキシー1, 3-ジェ 40チルジシロキサン、1,1,3,3-テトラメトキシー 1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テ トラエトキシー1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 1, 3, 3ーテトラフェノキシー1, 3ージフェニルジ シロキサン、1, 1, 3ートリメトキシー1, 3, 3ー トリメチルジシロキサン、1, 1, 3-トリエトキシー 1、3、3ートリメチルジシロキサン、1、1、3ート リフェノキシー1, 3, 3-トリメチルジシロキサン、 1, 1, 3ートリメトキシー1, 3, 3ートリエチルジ

ートリエチルジシロキサン、、1,1,3ートリフェノ キシー1, 3, 3ートリエチルジシロキサン、、1, 1, 3ートリメトキシー1, 3, 3ートリフェニルジシ ロキサン、1, 1, 3-トリエトキシー1, 3, 3-ト リフェニルジシロキサン、1、1、3-トリフェノキシ -1, 3, 3-メトキシー1, 1, 3, 3ーテトラメチルジシロキサ ン、1, 3-ジェトキシー1, 1, 3, 3-テトラメチ ルジシロキサン、1, 3-ジフェノキシー1, 1, 3, 10 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジメトキシー 1, 1, 3, 3-テトラエチルジシロキサン、1, 3-ジエトキシー1, 1, 3, 3ーテトラエチルジシロキサ ン、1, 3-ジフェノキシ-1, 1, 3, 3-テトラエ チルジシロキサン、1,3ージメトキシー1,1,3, 3-テトラフェニルジシロキサン、1,3-ジエトキシ -1, 1, 3, 3-r, -r, -r3-ジフェノキシ-1, 1, 3, 3-テトラフェニルジ シロキサンなどを挙げることができる。

【0014】これらのうち、ヘキサメトキシジシロキサ 20 ン、ヘキサエトキシジシロキサン、1,1,3,3-テ トラメトキシー1, 3ージメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシー1, 3-ジメチルジシロ . キサン、1, 1, 3, 3-テトラメトキシー1, 3-ジ ・ フェニルジシロキサン、1,3-ジメトキシー1,1, 3, 3ーテトラメチルジシロキサン、1, 3ージエトキ シ-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジメトキシー1、1、3、3-テトラフェニルジシ ロキサン、1, 3-ジエトキシ-1, 1, 3, 3-テト ラフェニルジシロキサンなどを、好ましい例として挙げ

【0015】また、一般式(3)において、dが0の化 合物としては、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキ シジシラン、ヘキサフェノキシジシラン、1,1,1, 2, 2ーペンタメトキシー2ーメチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2ーペンタエトキシー2ーメチルジシラ ν , 1, 1, 1, 2, 2- $^{\circ}\nu$ 97 $_{z}$ 7 ジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタメトキシー2 ーエチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2ーペンタエトキ シー2-エチルジシラン、1,1,1,2,2-ペンタ フェノキシー2-エチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2 ーペンタメトキシー2ーフェニルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタエトキシー2-フェニルジシラン、 1, 1, 1, 2, 2ーペンタフェノキシー2ーフェニル ジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシー1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエトキシー 1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラフ ェノキシー1, 2ージメチルジシラン、1, 1, 2, 2 ーテトラメトキシー1, 2-ジエチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエトキシー1, 2-ジエチルジシラ シロキサン、、1, 1, 3ートリエトキシー1, 3, 3 50 ン、1, 1, 2, 2ーテトラフェノキシー1, 2ージエ

チルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシー1, 2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエト キシー1, 2ージフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラフェノキシー1, 2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2-トリメトキシー1, 2, 2-トリメチルジシラ ン、1, 1, 2ートリエトキシー1, 2, 2ートリメチ ルジシラン、1, 1, 2ートリフェノキシー1, 2, 2 ートリメチルジシラン、1,1,2ートリメトキシー 1, 2, 2ートリエチルジシラン、、1, 1, 2ートリ エトキシー1, 2, 2ートリエチルジシラン、、1, 1, 2-トリフェノキシー1, 2, 2-トリエチルジシ ラン、、1, 1, 2ートリメトキシー1, 2, 2ートリ フェニルジシラン、1,1,2-トリエトキシー1, 2, 2-トリフェニルジシラン、、1, 1, 2-トリフ ェノキシー1, 2, 2-トリフェニルジシラン、1, 2 ージメトキシー1, 1, 2, 2ーテトラメチルジシラ ν , 1, 2- ν x + ν - 1, 1, 2, 2- ν + ν + ν ルジシラン、1, 2-ジフェノキシ-1, 1, 2, 2-テトラメチルジシラン、1, 2-ジメトキシー1, 1, 2, 2-テトラエチルジシラン、1, 2-ジェトキシー 1, 1, 2, 2ーテトラエチルジシラン、1, 2ージフ ェノキシー1, 1, 2, 2ーテトラエチルジシラン、 1, 2-ジメトキシー1, 1, 2, 2-テトラフェニル ジシラン、1, 2-ジエトキシ-1, 1, 2, 2-テト ラフェニルジシラン、1, 2-ジフェノキシー1, 1, 2, 2ーテトラフェニルジシランなどを挙げることがで

【0016】これらのうち、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキシジシラン、1,1,2,2ーテトラメトキシー1,2ージメチルジシラン、1,1,2,2ーテ 30トラエトキシー1,2ージメチルジシラン、1,1,2ーデトラメトキシー1,2ージフェニルジシラン、1,2ージメトキシー1,1,2,2ーテトラメチルジシラン、1,2ージエトキシー1,1,2ージエトキシー1,1,2,2ーテトラフェニルジシラン、1,2ージエトキシー1,1,2,2ーテトラフェニルジシランなどを、好ましい例として挙げることができる。

ン、1, 2-ビス (トリーsecープトキシシリル) エ タン、1, 2-ビス (トリーtープトキシシリル) エタ ン、1-(ジメトキシメチルシリル)-1-(トリメト キシシリル) メタン、1-(ジエトキシメチルシリル) -1- (トリエトキシシリル) メタン、1-(ジーn-プロポキシメチルシリル) -1- (トリーn-プロポキ シシリル) メタン、1 - (ジ-i-プロポキシメチルシ リル) -1- (トリーi-プロポキシシリル) メタン、 1- (ジーn-ブトキシメチルシリル) -1- (トリー 10 nープトキシシリル) メタン、1ー (ジーsecープト キシメチルシリル) -1- (トリーsec-ブトキシシ リル) メタン、1-(ジ-t-ブトキシメチルシリル) -1-(トリーt-ブトキシシリル)メタン、1-(ジ メトキシメチルシリル) -2-(トリメトキシシリル) エタン、1-(ジエトキシメチルシリル)-2-(トリ エトキシシリル) エタン、1-(ジ-n-プロポキシメ チルシリル) -2- (トリーn-プロポキシシリル) エ タン、1-(ジーi-プロポキシメチルシリル)-2-(トリーi-プロポキシシリル) エタン、1-(ジーn 20 ーブトキシメチルシリル) -2- (トリーn-ブトキシ シリル) エタン、1- (ジーsec-ブトキシメチルシ リル) -2- (トリーsec-ブトキシシリル) エタ ン、1-(ジ-t-ブトキシメチルシリル)-2-(ト リー t ープトキシシリル) エタン、ビス (ジメトキシメ チルシリル) メタン、ビス (ジエトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジーnープロポキシメチルシリル) メタ・ ン、ビス (ジーiープロポキシメチルシリル) メタン、 ビス (ジーn-ブトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジ-sec-ブトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジーtープトキシメチルシリル) メタン、1, 2-ビ ス (ジメトキシメチルシリル) エタン、1, 2ービス (ジエトキシメチルシリル) エタン、1,2-ビス(ジ -n-プロポキシメチルシリル) エタン、1,2-ビス (ジーiープロポキシメチルシリル) エタン、1, 2-ビス (ジーn-ブトキシメチルシリル) エタン、1,2 ービス (ジーsecーブトキシメチルシリル) エタン、 1, 2-ビス (ジーt-ブトキシメチルシリル) エタ ン、1,2-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1, 2-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、1, 2 40 ービス(トリーnープロポキシシリル)ベンゼン、1, 2-ビス(トリーi-プロポキシシリル)ベンゼン、 1, 2-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベンゼン、 1, 2-ビス (トリーsec-ブトキシシリル) ベンゼ ン、1, 2-ビス (トリ-t- ブトキシシリル) ベンゼ ン、1, 3-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1, 3-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1, 3 ービス(トリーnープロポキシシリル)ベンゼン、1, 3-ビス (トリーi-プロポキシシリル) ベンゼン、 1, 3-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベンゼン、

12

ン、1,3ービス(トリーtープトキシシリル)ベンゼ ン、1,4ービス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1, 4-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、1, 4 ービス (トリーnープロポキシシリル) ベンゼン、1. 4-ビス(トリーi-プロポキシシリル)ベンゼン、 1, 4ービス(トリーnープトキシシリル)ベンゼン、 1, 4-ビス(トリーsec-ブトキシシリル)ベンゼ ン、1、4ービス(トリーtープトキシシリル)ベンゼ ンなど挙げることができる。

【0018】 これらのうち、ピス(トリメトキシシリ ル) メタン、ビス(トリエトキシシリル) メタン、1, 2-ビス(トリメトキシシリル)エタン、1,2-ビス (トリエトキシシリル) エタン、1-(ジメトキシメチ ルシリル) -1- (トリメトキシシリル) メタン、1-**(ジエトキシメチルシリル)-1-(トリエトキシシリ** ル) メタン、1-(ジメトキシメチルシリル) -2-(トリメトキシシリル) エタン、1-(ジエトキシメチ ルシリル) ー2ー (トリエトキシシリル) エタン、ビス (ジメトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジエトキシ メチルシリル) メタン、1, 2-ビス (ジメトキシメチ 20 ルシリル) エタン、1, 2-ビス (ジエトキシメチルシ リル) エタン、1, 2-ビス (トリメトキシシリル) ベ ンゼン、1, 2-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼ ン、1,3-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1, 3-ピス (トリエトキシシリル) ベンゼン、1, 4 ービス(トリメトキシシリル)ベンゼン、1,4ービス (トリエトキシシリル) ベンゼンなどを好ましい例とし て挙げることができる。本発明において、(A)成分を 構成する化合物(1)~(3)としては、上記化合物 用いることができる。なお、(A)成分中、各成分を完 全加水分解縮合物に換算したときに、化合物 (2) は、

> $(R^{\mathfrak{g}}R^{\mathfrak{g}}R^{\mathfrak{g}}R^{\mathfrak{g}}R^{\mathfrak{g}}N)$, $R^{\mathfrak{g}}$ $\cdots (4)$ R^{ii} $(R^{ii})_{k}$ $\cdots (5)$

(式中、R®~R"は同一または異なり、それぞれ水素 原子、炭素数1~10のアルキル基、ヒドロキシアルキ ル基、アリール基、アリールアルキル基を示し、R"は ハロゲン原子、1~4価のアニオン性基を示し、eは1 ~4の整数を示し、Rⁿ は窒素原子を含有するg 価の環 ニオン性基を示し、fは1~4の整数、gは1~fの整 数を示し、g・h≤fである。)

上記において炭素数1~10のアルキル基としては、メ チル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘキシル基 などを、アリール基としては、フェニル基、トリル基な どを、アリールアルキル基としては、ベンジル基など を、ハロゲン原子としては塩素原子、臭素原子などを示 す。1~4個のアニオン性基とは、1~4個のアニオン 性基を有する化合物に由来する基であり、窒素原子を含

化合物(1)~(3)の総量中、5~75重量%、好ま しくは10~70重量%、さらに好ましくは15~70 重量%である。また、化合物(1)および/または (3) は、化合物(1)~(3)の総量中、95~25 重量%、好ましくは90~30重量%、さらに好ましく は85~30重量%である。化合物(2)が、化合物 (1)~(3)の総量中、5~75重量%であること が、得られる途膜の弾性率が高く、かつ低誘電性に特に 優れる。ここで、本発明において、完全加水分解縮合物 10 とは、化合物 (1) ~ (3) 中のR' O-基, R' O-基, R'O-基およびR'O-基が100%加水分解し てSiOH基となり、さらに完全に縮合してシロキサン 構造となったものをいう。また、(A)成分としては、 得られる組成物の貯蔵安定性がより優れるので、化合物 (1) および化合物 (2) の加水分解縮合物であること が好ましい。

【0019】本発明の(A)加水分解縮合物を製造する に際しては、上記化合物(1) \sim (3) の群から選ばれ た少なくとも1種のシラン化合物を加水分解、縮合させ る際に、(B)成分を用いることが特徴である。本発明 において(B)成分を用いることにより、塗膜の比誘電 率の温度依存性とPCT後の比誘電率変化が少ないシリ カ系膜を得ることができる。本発明で使用することので きる窒素オニウム塩化合物は、(B-1)窒素含有化合 物と(B-2)アニオン性基含有化合物およびハロゲン 化合物から選ばれる少なくとも1種とから形成される塩 である。本発明において、アニオン性基としては、水酸 基、硝酸基、カーボネート基、カルボキシル基、スルホ ニル基、ホスホニル基、カルボニル基およびフェノキシ (1)、(2) および(3) の1種もしくは2種以上を 30 基である。(B) 成分としては、、下記一般式(4) で 表される化合物および一般式 (5) で表される化合物を 挙げることができる。

有する芳香族化合物、g個の窒素原子を有する複素環化 合物、g個の窒素原子を有する脂肪族環化合物に由来す る基である。

【0020】一般式(4)で表される化合物としては、 例えば、水酸化アンモニウム、塩化アンモニウム、臭化 状カチオン性基を示し、R"はハロゲン原子、f価のア 40 アンモニウム、沃化アンモニウム、フッ化アンモニウ ム、硝酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、硫酸水素ア ンモニウム、リン酸アンモニウム、炭酸アンモニウム、 フェノールアンモニウム、酢酸アンモニウム、アジピン 酸アンモニウム、アルギン酸アンモニウム、安息香酸ア ンモニウム、硫酸アンモニウム、クエン酸アンモニウ ム、ギ酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム、フタル 酸アンモニウム、サリチル酸アンモニウム、コハク酸ア ンモニウム、マレイン酸アンモニウム、プロピオン酸ア ンモニウム、ブタン酸アンモニウム、ペンタン酸アンモ 有するg価の環状カチオン性基とは、g個の窒素原子を 50 ニウム、ヘキサン酸アンモニウム、ヘプタン酸アンモニ

14

ウム、オクタン酸アンモニウム、ノナン酸アンモニウ ム、デカン酸アンモニウム、シュウ酸アンモニウム、メ チルマロン酸アンモニウム、セパシン酸アンモニウム、 没食子酸アンモニウム、酪酸アンモニウム、メリット酸 アンモニウム、アラキドン酸アンモニウム、シキミ酸ア ンモニウム、2-エチルヘキサン酸アンモニウム、オレ イン酸アンモニウム、ステアリン酸アンモニウム、リノ ール酸アンモニウム、リノレイン酸アンモニウム、pー アミノ安息香酸アンモニウム、p-トルエンスルホン酸 アンモニウム、ベンゼンスルホン酸アンモニウム、モノ 10 ジメチルアンモニウム、安息香酸ジメチルアンモニウ クロロ酢酸アンモニウム、ジクロロ酢酸アンモニウム、 トリクロロ酢酸アンモニウム、トリフルオロ酢酸アンモ ニウム、マロン酸アンモニウム、スルホン酸アンモニウ ム、フマル酸アンモニウム、酒石酸アンモニウム、イタ コン酸アンモニウム、メサコン酸アンモニウム、シトラ コン酸アンモニウム、リンゴ酸アンモニウム、グルタル 酸アンモニウム; 水酸化メチルアンモニウム、塩化メチ ルアンモニウム、臭化メチルアンモニウム、沃化メチル アンモニウム、フッ化メチルアンモニウム、硝酸メチル ルアンモニウム、リン酸メチルアンモニウム、炭酸メチ ルアンモニウム、フェノールメチルアンモニウム、酢酸 メチルアンモニウム、アジピン酸メチルアンモニウム、 アルギン酸メチルアンモニウム、安息香酸メチルアンモ ニウム、硫酸メチルアンモニウム、クエン酸メチルアン モニウム、ギ酸メチルアンモニウム、炭酸水素メチルア ンモニウム、フタル酸メチルアンモニウム、サリチル酸 メチルアンモニウム、コハク酸メチルアンモニウム、マ レイン酸メチルアンモニウム、プロピオン酸メチルアン モニウム、ブタン酸メチルアンモニウム、ペンタン酸メ チルアンモニウム、ヘキサン酸メチルアンモニウム、ヘ プタン酸メチルアンモニウム、オクタン酸メチルアンモ ニウム、ノナン酸メチルアンモニウム、デカン酸メチル アンモニウム、シュウ酸メチルアンモニウム、メチルマ ロン酸メチルアンモニウム、セバシン酸メチルアンモニ ウム、没食子酸メチルアンモニウム、酪酸メチルアンモ ニウム、メリット酸メチルアンモニウム、アラキドン酸 メチルアンモニウム、シキミ酸メチルアンモニウム、2 -エチルヘキサン酸メチルアンモニウム、オレイン酸メ チルアンモニウム、ステアリン酸メチルアンモニウム、 リノール酸メチルアンモニウム、リノレイン酸メチルア ンモニウム、pーアミノ安息香酸メチルアンモニウム、 pートルエンスルホン酸メチルアンモニウム、ベンゼン スルホン酸メチルアンモニウム、モノクロロ酢酸メチル アンモニウム、ジクロロ酢酸メチルアンモニウム、トリ クロロ酢酸メチルアンモニウム、トリフルオロ酢酸メチ ルアンモニウム、マロン酸メチルアンモニウム、スルホ ン酸メチルアンモニウム、フマル酸メチルアンモニウ ム、酒石酸メチルアンモニウム、イタコン酸メチルアン

酸メチルアンモニウム、リンゴ酸メチルアンモニウム、 グルタル酸メチルアンモニウム; 水酸化ジメチルアンモ ニウム、塩化ジメチルアンモニウム、臭化ジメチルアン モニウム、沃化ジメチルアンモニウム、フッ化ジメチル アンモニウム、硝酸ジメチルアンモニウム、硫酸ジメチ ルアンモニウム、硫酸水素ジメチルアンモニウム、リン 酸ジメチルアンモニウム、炭酸ジメチルアンモニウム、 フェノールジメチルアンモニウム、酢酸ジメチルアンモ ニウム、アジピン酸ジメチルアンモニウム、アルギン酸 ム、硫酸ジメチルアンモニウム、クエン酸ジメチルアン モニウム、ギ酸ジメチルアンモニウム、炭酸水素ジメチ ルアンモニウム、フタル酸ジメチルアンモニウム、サリ チル酸ジメチルアンモニウム、コハク酸ジメチルアンモ ニウム、マレイン酸ジメチルアンモニウム、プロピオン 酸ジメチルアンモニウム、ブタン酸ジメチルアンモニウ ム、ペンタン酸ジメチルアンモニウム、ヘキサン酸ジメ チルアンモニウム、ヘプタン酸ジメチルアンモニウム、 オクタン酸ジメチルアンモニウム、ノナン酸ジメチルア アンモニウム、硫酸メチルアンモニウム、硫酸水素メチ 20 ンモニウム、デカン酸ジメチルアンモニウム、シュウ酸 ジメチルアンモニウム、メチルマロン酸ジメチルアンモ ニウム、セバシン酸ジメチルアンモニウム、没食子酸ジ メチルアンモニウム、酪酸ジメチルアンモニウム、メリ ット酸ジメチルアンモニウム、アラキドン酸ジメチルア ンモニウム、シキミ酸ジメチルアンモニウム、2-エチ ルヘキサン酸ジメチルアンモニウム、オレイン酸ジメチ ルアンモニウム、ステアリン酸ジメチルアンモニウム、 リノール酸ジメチルアンモニウム、リノレイン酸ジメチ ルアンモニウム、p-アミノ安息香酸ジメチルアンモニ ウム、pートルエンスルホン酸ジメチルアンモニウム、 ベンゼンスルホン酸ジメチルアンモニウム、モノクロロ 酢酸ジメチルアンモニウム、ジクロロ酢酸ジメチルアン モニウム、トリクロロ酢酸ジメチルアンモニウム、トリ フルオロ酢酸ジメチルアンモニウム、マロン酸ジメチル アンモニウム、スルホン酸ジメチルアンモニウム、フマ ル酸ジメチルアンモニウム、酒石酸ジメチルアンモニウ ム、イタコン酸ジメチルアンモニウム、メサコン酸ジメ・ チルアンモニウム、シトラコン酸ジメチルアンモニウ ム、リンゴ酸ジメチルアンモニウム、グルタル酸ジメチ 40 ルアンモニウム; 水酸化トリメチルアンモニウム、塩化 トリメチルアンモニウム、臭化トリメチルアンモニウ ム、沃化トリメチルアンモニウム、フッ化トリメチルア ンモニウム、硝酸トリメチルアンモニウム、硫酸トリメ チルアンモニウム、硫酸水素トリメチルアンモニウム、 リン酸トリメチルアンモニウム、炭酸トリメチルアンモ ニウム、フェノールトリメチルアンモニウム、酢酸トリ メチルアンモニウム、アジピン酸トリメチルアンモニウ ム、アルギン酸トリメチルアンモニウム、安息香酸トリ メチルアンモニウム、硫酸トリメチルアンモニウム、ク モニウム、メサコン酸メチルアンモニウム、シトラコン 50 エン酸トリメチルアンモニウム、ギ酸トリメチルアンモ

ニウム、炭酸水素トリメチルアンモニウム、フタル酸ト リメチルアンモニウム、サリチル酸トリメチルアンモニ ウム、コハク酸トリメチルアンモニウム、マレイン酸ト リメチルアンモニウム、プロピオン酸トリメチルアンモ ニウム、ブタン酸トリメチルアンモニウム、ペンタン酸 トリメチルアンモニウム、ヘキサン酸トリメチルアンモ ニウム、ヘプタン酸トリメチルアンモニウム、オクタン 酸トリメチルアンモニウム、ノナン酸トリメチルアンモ ニウム、デカン酸トリメチルアンモニウム、シュウ酸ト リメチルアンモニウム、メチルマロン酸トリメチルアン モニウム、セバシン酸トリメチルアンモニウム、没食子 酸トリメチルアンモニウム、酪酸トリメチルアンモニウ ム、メリット酸トリメチルアンモニウム、アラキドン酸 トリメチルアンモニウム、シキミ酸トリメチルアンモニ ウム、2-エチルヘキサン酸トリメチルアンモニウム、 オレイン酸トリメチルアンモニウム、ステアリン酸トリ メチルアンモニウム、リノール酸トリメチルアンモニウ ム、リノレイン酸トリメチルアンモニウム、p-アミノ 安息香酸トリメチルアンモニウム、p-トルエンスルホ ン酸トリメチルアンモニウム、ベンゼンスルホン酸トリ メチルアンモニウム、モノクロロ酢酸トリメチルアンモ ニウム、ジクロロ酢酸トリメチルアンモニウム、トリク ロロ酢酸トリメチルアンモニウム、トリフルオロ酢酸ト リメチルアンモニウム、マロン酸トリメチルアンモニウ ム、スルホン酸トリメチルアンモニウム、フマル酸トリ メチルアンモニウム、酒石酸トリメチルアンモニウム、 イタコン酸トリメチルアンモニウム、メサコン酸トリメ チルアンモニウム、シトラコン酸トリメチルアンモニウ ム、リンゴ酸トリメチルアンモニウム、グルタル酸トリ エチルアンモニウム、臭化エチルアンモニウム、沃化エ チルアンモニウム、フッ化エチルアンモニウム、硝酸エ チルアンモニウム、硫酸エチルアンモニウム、硫酸水素 エチルアンモニウム、リン酸エチルアンモニウム、炭酸 エチルアンモニウム、フェノールエチルアンモニウム、 酢酸エチルアンモニウム、アジピン酸エチルアンモニウ ム、アルギン酸エチルアンモニウム、安息香酸エチルア ンモニウム、硫酸エチルアンモニウム、クエン酸エチル アンモニウム、ギ酸エチルアンモニウム、炭酸水素エチ ル酸エチルアンモニウム、コハク酸エチルアンモニウ ム、マレイン酸エチルアンモニウム、プロピオン酸エチ ルアンモニウム、ブタン酸エチルアンモニウム、ペンタ ン酸エチルアンモニウム、ヘキサン酸エチルアンモニウ ム、ヘプタン酸エチルアンモニウム、オクタン酸エチル アンモニウム、ノナン酸エチルアンモニウム、デカン酸 エチルアンモニウム、シュウ酸エチルアンモニウム、メ チルマロン酸エチルアンモニウム、セバシン酸エチルア ンモニウム、没食子酸エチルアンモニウム、酪酸エチル アンモニウム、メリット酸エチルアンモニウム、アラキ 50 ンモニウム、イタコン酸ジエチルアンモニウム、メサコ

ドン酸エチルアンモニウム、シキミ酸エチルアンモニウ ム、2-エチルヘキサン酸エチルアンモニウム、オレイ ン酸エチルアンモニウム、ステアリン酸エチルアンモニ ウム、リノール酸エチルアンモニウム、リノレイン酸エ チルアンモニウム、p-アミノ安息香酸エチルアンモニ ウム、p-トルエンスルホン酸エチルアンモニウム、ベ ンゼンスルホン酸エチルアンモニウム、モノクロロ酢酸 エチルアンモニウム、ジクロロ酢酸エチルアンモニウ ム、トリクロロ酢酸エチルアンモニウム、トリフルオロ 酢酸エチルアンモニウム、マロン酸エチルアンモニウ ム、スルホン酸エチルアンモニウム、フマル酸エチルア ンモニウム、酒石酸エチルアンモニウム、イタコン酸エ チルアンモニウム、メサコン酸エチルアンモニウム、シ トラコン酸エチルアンモニウム、リンゴ酸エチルアンモ ニウム、グルタル酸エチルアンモニウム: 水酸化ジエチ ルアンモニウム、塩化ジエチルアンモニウム、臭化ジエ チルアンモニウム、沃化ジエチルアンモニウム、フッ化 ジエチルアンモニウム、硝酸ジエチルアンモニウム、硫 酸ジエチルアンモニウム、硫酸水素ジエチルアンモニウ ム、リン酸ジエチルアンモニウム、炭酸ジエチルアンモ ニウム、フェノールジエチルアンモニウム、酢酸ジエチ ルアンモニウム、アジピン酸ジエチルアンモニウム、ア ルギン酸ジエチルアンモニウム、安息香酸ジエチルアン モニウム、硫酸ジエチルアンモニウム、クエン酸ジエチ ルアンモニウム、ギ酸ジエチルアンモニウム、炭酸水素 ジエチルアンモニウム、フタル酸ジエチルアンモニウ ム、サリチル酸ジエチルアンモニウム、コハク酸ジエチ ルアンモニウム、マレイン酸ジエチルアンモニウム、プ ロピオン酸ジエチルアンモニウム、ブタン酸ジエチルア メチルアンモニウム: 水酸化エチルアンモニウム、塩化 30 ンモニウム、ペンタン酸ジエチルアンモニウム、ヘキサ ン酸ジエチルアンモニウム、ヘプタン酸ジエチルアンモ ニウム、オクタン酸ジエチルアンモニウム、ノナン酸ジ エチルアンモニウム、デカン酸ジエチルアンモニウム、 シュウ酸ジエチルアンモニウム、メチルマロン酸ジエチ ルアンモニウム、セバシン酸ジエチルアンモニウム、没 食子酸ジエチルアンモニウム、酪酸ジエチルアンモニウ ム、メリット酸ジエチルアンモニウム、アラキドン酸ジ エチルアンモニウム、シキミ酸ジエチルアンモニウム、 2-エチルヘキサン酸ジエチルアンモニウム、オレイン ルアンモニウム、フタル酸エチルアンモニウム、サリチ 40 酸ジエチルアンモニウム、ステアリン酸ジエチルアンモ ニウム、リノール酸ジエチルアンモニウム、リノレイン 酸ジエチルアンモニウム、p-アミノ安息香酸ジエチル アンモニウム、pートルエンスルホン酸ジエチルアンモ ニウム、ベンゼンスルホン酸ジエチルアンモニウム、モ ノクロロ酢酸ジエチルアンモニウム、ジクロロ酢酸ジエ チルアンモニウム、トリクロロ酢酸ジエチルアンモニウ ム、トリフルオロ酢酸ジエチルアンモニウム、マロン酸 ジエチルアンモニウム、スルホン酸ジエチルアンモニウ ム、フマル酸ジエチルアンモニウム、酒石酸ジエチルア

17

ン酸ジエチルアンモニウム、シトラコン酸ジエチルアン モニウム、リンゴ酸ジエチルアンモニウム、グルタル酸 ジエチルアンモニウム: 水酸化トリエチルアンモニウ ム、塩化トリエチルアンモニウム、臭化トリエチルアン モニウム、沃化トリエチルアンモニウム、フッ化トリエ チルアンモニウム、硝酸トリエチルアンモニウム、硫酸 トリエチルアンモニウム、硫酸水素トリエチルアンモニ ウム、リン酸トリエチルアンモニウム、炭酸トリエチル アンモニウム、フェノールトリエチルアンモニウム、酢 モニウム、アルギン酸トリエチルアンモニウム、安息香 酸トリエチルアンモニウム、硫酸トリエチルアンモニウ ム、クエン酸トリエチルアンモニウム、ギ酸トリエチル アンモニウム、炭酸水素トリエチルアンモニウム、フタ ル酸トリエチルアンモニウム、サリチル酸トリエチルア ンモニウム、コハク酸トリエチルアンモニウム、マレイ ン酸トリエチルアンモニウム、プロピオン酸トリエチル アンモニウム、ブタン酸トリエチルアンモニウム、ペン タン酸トリエチルアンモニウム、ヘキサン酸トリエチル アンモニウム、ヘプタン酸トリエチルアンモニウム、オ 20 クタン酸トリエチルアンモニウム、ノナン酸トリエチル アンモニウム、デカン酸トリエチルアンモニウム、シュ ウ酸トリエチルアンモニウム、メチルマロン酸トリエチ ルアンモニウム、セバシン酸トリエチルアンモニウム、 没食子酸トリエチルアンモニウム、酪酸トリエチルアン モニウム、メリット酸トリエチルアンモニウム、アラキ ドン酸トリエチルアンモニウム、シキミ酸トリエチルア ンモニウム、2-エチルヘキサン酸トリエチルアンモニ ウム、オレイン酸トリエチルアンモニウム、ステアリン 酸トリエチルアンモニウム、リノール酸トリエチルアン 30 モニウム、リノレイン酸トリエチルアンモニウム、p-アミノ安息香酸トリエチルアンモニウム、pートルエン スルホン酸トリエチルアンモニウム、ベンゼンスルホン 酸トリエチルアンモニウム、モノクロロ酢酸トリエチル アンモニウム、ジクロロ酢酸トリエチルアンモニウム、 トリクロロ酢酸トリエチルアンモニウム、トリフルオロ 酢酸トリエチルアンモニウム、マロン酸トリエチルアン モニウム、スルホン酸トリエチルアンモニウム、フマル 酸トリエチルアンモニウム、酒石酸トリエチルアンモニ トリエチルアンモニウム、シトラコン酸トリエチルアン モニウム、リンゴ酸トリエチルアンモニウム、グルタル 酸トリエチルアンモニウム: 水酸化トリプロピルアンモ ニウム、塩化トリプロピルアンモニウム、臭化トリプロ ピルアンモニウム、沃化トリプロピルアンモニウム、フ ッ化トリプロピルアンモニウム、硝酸トリプロピルアン モニウム、硫酸トリプロピルアンモニウム、硫酸水素ト リプロピルアンモニウム、リン酸トリプロピルアンモニ ウム、炭酸トリプロピルアンモニウム、フェノールトリ プロピルアンモニウム、酢酸トリプロピルアンモニウ

ム、アジピン酸トリプロピルアンモニウム、アルギン酸 トリプロピルアンモニウム、安息香酸トリプロピルアン モニウム、硫酸トリプロピルアンモニウム、クエン酸ト リプロピルアンモニウム、ギ酸トリプロピルアンモニウ ム、炭酸水素トリプロピルアンモニウム、フタル酸トリ プロピルアンモニウム、サリチル酸トリプロピルアンモ ニウム、コハク酸トリプロピルアンモニウム、マレイン 酸トリプロピルアンモニウム、プロピオン酸トリプロピ ルアンモニウム、ブタン酸トリプロピルアンモニウム、 酸トリエチルアンモニウム、アジピン酸トリエチルアン 10 ペンタン酸トリプロピルアンモニウム、ヘキサン酸トリ プロピルアンモニウム、ヘプタン酸トリプロピルアンモ ニウム、オクタン酸トリプロピルアンモニウム、ノナン・ 酸トリプロピルアンモニウム、デカン酸トリプロピルア ンモニウム、シュウ酸トリプロピルアンモニウム、メチ ルマロン酸トリプロピルアンモニウム、セバシン酸トリ プロピルアンモニウム、没食子酸トリプロピルアンモニ ウム、酪酸トリプロピルアンモニウム、メリット酸トリ プロピルアンモニウム、アラキドン酸トリプロピルアン モニウム、シキミ酸トリプロピルアンモニウム、2-エ チルヘキサン酸トリプロピルアンモニウム、オレイン酸 トリプロピルアンモニウム、ステアリン酸トリプロピル アンモニウム、リノール酸トリプロピルアンモニウム、 リノレイン酸トリプロピルアンモニウム、pーアミノ安 息香酸トリプロピルアンモニウム、pートルエンスルホ ン酸トリプロピルアンモニウム、ベンゼンスルホン酸ト リプロピルアンモニウム、モノクロロ酢酸トリプロピル アンモニウム、ジクロロ酢酸トリプロピルアンモニウ ム、トリクロロ酢酸トリプロピルアンモニウム、トリフ ルオロ酢酸トリプロピルアンモニウム、マロン酸トリプ ロピルアンモニウム、スルホン酸トリプロピルアンモニ ウム、フマル酸トリプロピルアンモニウム、酒石酸トリ プロピルアンモニウム、イタコン酸トリプロピルアンモ ニウム、メサコン酸トリプロピルアンモニウム、シトラ コン酸トリプロピルアンモニウム、リンゴ酸トリプロピ ルアンモニウム、グルタル酸トリプロピルアンモニウ ム;水酸化トリブチルアンモニウム、塩化トリブチルア ンモニウム、臭化トリプチルアンモニウム、沃化トリブ チルアンモニウム、フッ化トリブチルアンモニウム、硝 酸トリブチルアンモニウム、硫酸トリブチルアンモニウ ウム、イタコン酸トリエチルアンモニウム、メサコン酸 40 ム、硫酸水素トリブチルアンモニウム、リン酸トリブチ ルアンモニウム、炭酸トリブチルアンモニウム、フェノ ールトリブチルアンモニウム、酢酸トリブチルアンモニ ウム、アジピン酸トリブチルアンモニウム、アルギン酸 トリブチルアンモニウム、安息香酸トリブチルアンモニ ウム、硫酸トリプチルアンモニウム、クエン酸トリブチ ルアンモニウム、ギ酸トリブチルアンモニウム、炭酸水 素トリプチルアンモニウム、フタル酸トリブチルアンモ ニウム、サリチル酸トリプチルアンモニウム、コハク酸 トリブチルアンモニウム、マレイン酸トリブチルアンモ 50 ニウム、プロピオン酸トリブチルアンモニウム、ブタン

酸トリブチルアンモニウム、ペンタン酸トリブチルアン モニウム、ヘキサン酸トリブチルアンモニウム、ヘプタ ン酸トリプチルアンモニウム、オクタン酸トリプチルア ンモニウム、ノナン酸トリブチルアンモニウム、デカン 酸トリブチルアンモニウム、シュウ酸トリブチルアンモ ニウム、メチルマロン酸トリプチルアンモニウム、セバ シン酸トリブチルアンモニウム、没食子酸トリブチルア ンモニウム、酪酸トリブチルアンモニウム、メリット酸 トリブチルアンモニウム、アラキドン酸トリブチルアン モニウム、シキミ酸トリプチルアンモニウム、2-エチ 10 ルヘキサン酸トリブチルアンモニウム、オレイン酸トリ ブチルアンモニウム、ステアリン酸トリブチルアンモニ ウム、リノール酸トリプチルアンモニウム、リノレイン 酸トリプチルアンモニウム、pーアミノ安息香酸トリブ チルアンモニウム、pートルエンスルホン酸トリブチル アンモニウム、ベンゼンスルホン酸トリブチルアンモニ ウム、モノクロロ酢酸トリプチルアンモニウム、ジクロ 口酢酸トリブチルアンモニウム、トリクロロ酢酸トリブ チルアンモニウム、トリフルオロ酢酸トリブチルアンモ ニウム、マロン酸トリブチルアンモニウム、スルホン酸 20 トリプチルアンモニウム、フマル酸トリプチルアンモニ ウム、酒石酸トリブチルアンモニウム、イタコン酸トリ ブチルアンモニウム、メサコン酸トリブチルアンモニウ ム、シトラコン酸トリブチルアンモニウム、リンゴ酸ト リブチルアンモニウム、グルタル酸トリブチルアンモニ ウム: 水酸化テトラメチルアンモニウム、塩化テトラメ チルアンモニウム、臭化テトラメチルアンモニウム、沃 化テトラメチルアンモニウム、フッ化テトラメチルアン モニウム、硝酸テトラメチルアンモニウム、硫酸テトラ メチルアンモニウム、硫酸水素テトラメチルアンモニウ 30 モニウム、炭酸水素テトラエチルアンモニウム、フタル ム、リン酸テトラメチルアンモニウム、炭酸テトラメチ ルアンモニウム、フェノールテトラメチルアンモニウ ム、酢酸テトラメチルアンモニウム、アジピン酸テトラ メチルアンモニウム、アルギン酸テトラメチルアンモニ ウム、安息香酸テトラメチルアンモニウム、硫酸テトラ メチルアンモニウム、クエン酸テトラメチルアンモニウ ム、ギ酸テトラメチルアンモニウム、炭酸水素テトラメ チルアンモニウム、フタル酸テトラメチルアンモニウ ム、サリチル酸テトラメチルアンモニウム、コハク酸テ トラメチルアンモニウム、マレイン酸テトラメチルアン 40 ム、メチルマロン酸テトラエチルアンモニウム、セバシ モニウム、プロピオン酸テトラメチルアンモニウム、ブ タン酸テトラメチルアンモニウム、ペンタン酸テトラメ チルアンモニウム、ヘキサン酸テトラメチルアンモニウ ム、ヘプタン酸テトラメチルアンモニウム、オクタン酸 テトラメチルアンモニウム、ノナン酸テトラメチルアン モニウム、デカン酸テトラメチルアンモニウム、シュウ 酸テトラメチルアンモニウム、メチルマロン酸テトラメ チルアンモニウム、セバシン酸テトラメチルアンモニウ ム、没食子酸テトラメチルアンモニウム、酪酸テトラメ チルアンモニウム、メリット酸テトラメチルアンモニウ

ム、アラキドン酸テトラメチルアンモニウム、シキミ酸 テトラメチルアンモニウム、2-エチルヘキサン酸テト ラメチルアンモニウム、オレイン酸テトラメチルアンモ ニウム、ステアリン酸テトラメチルアンモニウム、リノ ール酸テトラメチルアンモニウム、リノレイン酸テトラ メチルアンモニウム、pーアミノ安息香酸テトラメチル アンモニウム、pートルエンスルホン酸テトラメチルア ンモニウム、ベンゼンスルホン酸テトラメチルアンモニ ウム、モノクロロ酢酸テトラメチルアンモニウム、ジク ロロ酢酸テトラメチルアンモニウム、トリクロロ酢酸テ トラメチルアンモニウム、トリフルオロ酢酸テトラメチ ルアンモニウム、マロン酸テトラメチルアンモニウム、 スルホン酸テトラメチルアンモニウム、フマル酸テトラ メチルアンモニウム、酒石酸テトラメチルアンモニウ ム、イタコン酸テトラメチルアンモニウム、メサコン酸 テトラメチルアンモニウム、シトラコン酸テトラメチル アンモニウム、リンゴ酸テトラメチルアンモニウム、グ ルタル酸テトラメチルアンモニウム; 水酸化テトラエチ ルアンモニウム、塩化テトラエチルアンモニウム、臭化 テトラエチルアンモニウム、沃化テトラエチルアンモニ ウム、フッ化テトラエチルアンモニウム、硝酸テトラエ チルアンモニウム、硫酸テトラエチルアンモニウム、硫 酸水素テトラエチルアンモニウム、リン酸テトラエチル アンモニウム、炭酸テトラエチルアンモニウム、フェノ ールテトラエチルアンモニウム、酢酸テトラエチルアン モニウム、アジピン酸テトラエチルアンモニウム、アル ギン酸テトラエチルアンモニウム、安息香酸テトラエチ ルアンモニウム、硫酸テトラエチルアンモニウム、クエ ン酸テトラエチルアンモニウム、ギ酸テトラエチルアン 酸テトラエチルアンモニウム、サリチル酸テトラエチル アンモニウム、コハク酸テトラエチルアンモニウム、マ・ レイン酸テトラエチルアンモニウム、プロピオン酸テト ラエチルアンモニウム、ブタン酸テトラエチルアンモニ ウム、ペンタン酸テトラエチルアンモニウム、ヘキサン 酸テトラエチルアンモニウム、ヘプタン酸テトラエチル アンモニウム、オクタン酸テトラエチルアンモニウム、 ノナン酸テトラエチルアンモニウム、デカン酸テトラエ チルアンモニウム、シュウ酸テトラエチルアンモニウ ン酸テトラエチルアンモニウム、没食子酸テトラエチル アンモニウム、酪酸テトラエチルアンモニウム、メリッ ト酸テトラエチルアンモニウム、アラキドン酸テトラエ チルアンモニウム、シキミ酸テトラエチルアンモニウ ム、2-エチルヘキサン酸テトラエチルアンモニウム、 オレイン酸テトラエチルアンモニウム、ステアリン酸テ トラエチルアンモニウム、リノール酸テトラエチルアン モニウム、リノレイン酸テトラエチルアンモニウム、p -アミノ安息香酸テトラエチルアンモニウム、p-トル 50 エンスルホン酸テトラエチルアンモニウム、ベンゼンス

21

ルホン酸テトラエチルアンモニウム、モノクロロ酢酸テ トラエチルアンモニウム、ジクロロ酢酸テトラエチルア ンモニウム、トリクロロ酢酸テトラエチルアンモニウ ム、トリフルオロ酢酸テトラエチルアンモニウム、マロ ン酸テトラエチルアンモニウム、スルホン酸テトラエチ ルアンモニウム、フマル酸テトラエチルアンモニウム、 酒石酸テトラエチルアンモニウム、イタコン酸テトラエ チルアンモニウム、メサコン酸テトラエチルアンモニウ ム、シトラコン酸テトラエチルアンモニウム、リンゴ酸 テトラエチルアンモニウム、グルタル酸テトラエチルア ンモニウム; 水酸化テトラプロピルアンモニウム、塩化 テトラプロピルアンモニウム、臭化テトラプロピルアン モニウム、沃化テトラプロピルアンモニウム、フッ化テ トラプロピルアンモニウム、硝酸テトラプロピルアンモ ニウム、硫酸テトラプロピルアンモニウム、硫酸水素テ トラプロピルアンモニウム、リン酸テトラプロピルアン モニウム、炭酸テトラプロピルアンモニウム、フェノー ルテトラプロピルアンモニウム、酢酸テトラプロピルア ンモニウム、アジピン酸テトラプロピルアンモニウム、 ラプロピルアンモニウム、硫酸テトラプロピルアンモニ ウム、クエン酸テトラプロピルアンモニウム、ギ酸テト ラプロピルアンモニウム、炭酸水素テトラプロピルアン モニウム、フタル酸テトラプロピルアンモニウム、サリ チル酸テトラプロピルアンモニウム、コハク酸テトラプ ロピルアンモニウム、マレイン酸テトラプロピルアンモ ニウム、プロピオン酸テトラプロピルアンモニウム、ブ タン酸テトラプロピルアンモニウム、ペンタン酸テトラ プロピルアンモニウム、ヘキサン酸テトラプロピルアン クタン酸テトラプロピルアンモニウム、ノナン酸テトラ プロピルアンモニウム、デカン酸テトラプロピルアンモ ニウム、シュウ酸テトラプロピルアンモニウム、メチル マロン酸テトラプロピルアンモニウム、セバシン酸テト ラプロピルアンモニウム、没食子酸テトラプロピルアン モニウム、酪酸テトラプロピルアンモニウム、メリット 酸テトラプロピルアンモニウム、アラキドン酸テトラプ ロピルアンモニウム、シキミ酸テトラプロピルアンモニ ウム、2-エチルヘキサン酸テトラプロピルアンモニウ ム、オレイン酸テトラプロピルアンモニウム、ステアリ ン酸テトラプロピルアンモニウム、リノール酸テトラプ ロピルアンモニウム、リノレイン酸テトラプロピルアン モニウム、pーアミノ安息香酸テトラプロピルアンモニ ウム、pートルエンスルホン酸テトラプロピルアンモニ ウム、ベンゼンスルホン酸テトラプロピルアンモニウ ム、モノクロロ酢酸テトラプロピルアンモニウム、ジク ロロ酢酸テトラプロピルアンモニウム、トリクロロ酢酸 テトラプロピルアンモニウム、トリフルオロ酢酸テトラ プロピルアンモニウム、マロン酸テトラプロピルアンモ ニウム、スルホン酸テトラプロピルアンモニウム、フマ 50 ニウム、臭化トリメチルベンジルアンモニウム、沃化ト

ル酸テトラプロピルアンモニウム、酒石酸テトラプロピ ルアンモニウム、イタコン酸テトラプロピルアンモニウ ム、メサコン酸テトラプロピルアンモニウム、シトラコ ン酸テトラプロピルアンモニウム、リンゴ酸テトラプロ ピルアンモニウム、グルタル酸テトラプロピルアンモニ ウム: 水酸化テトラブチルアンモニウム、塩化テトラブ チルアンモニウム、臭化テトラブチルアンモニウム、沃 化テトラブチルアンモニウム、フッ化テトラブチルアン モニウム、硝酸テトラブチルアンモニウム、硫酸テトラ 10 ブチルアンモニウム、硫酸水素テトラブチルアンモニウ ム、リン酸テトラブチルアンモニウム、炭酸テトラブチ ルアンモニウム、フェノールテトラブチルアンモニウ ム、酢酸テトラブチルアンモニウム、アジピン酸テトラ ブチルアンモニウム、アルギン酸テトラブチルアンモニ ウム、安息香酸テトラブチルアンモニウム、硫酸テトラ ブチルアンモニウム、クエン酸テトラブチルアンモニウ ム、ギ酸テトラブチルアンモニウム、炭酸水素テトラブ チルアンモニウム、フタル酸テトラブチルアンモニウ ム、サリチル酸テトラブチルアンモニウム、コハク酸テ アルギン酸テトラプロピルアンモニウム、安息香酸テト 20 トラブチルアンモニウム、マレイン酸テトラブチルアン モニウム、プロピオン酸テトラブチルアンモニウム、ブ タン酸テトラブチルアンモニウム、ペンタン酸テトラブ チルアンモニウム、ヘキサン酸テトラブチルアンモニウ ム、ヘプタン酸テトラブチルアンモニウム、オクタン酸 テトラブチルアンモニウム、ノナン酸テトラブチルアン モニウム、デカン酸テトラブチルアンモニウム、シュウ 酸テトラブチルアンモニウム、メチルマロン酸テトラブ チルアンモニウム、セバシン酸テトラブチルアンモニウ ム、没食子酸テトラブチルアンモニウム、酪酸テトラブ モニウム、ヘプタン酸テトラプロピルアンモニウム、オ 30 チルアンモニウム、メリット酸テトラブチルアンモニウ ム、アラキドン酸テトラブチルアンモニウム、シキミ酸 テトラブチルアンモニウム、2-エチルヘキサン酸テト ラブチルアンモニウム、オレイン酸テトラブチルアンモ ニウム、ステアリン酸テトラブチルアンモニウム、リノ ール酸テトラブチルアンモニウム、リノレイン酸テトラ ブチルアンモニウム、p-アミノ安息香酸テトラブチル アンモニウム、pートルエンスルホン酸テトラブチルア ンモニウム、ベンゼンスルホン酸テトラブチルアンモニ ウム、モノクロロ酢酸テトラブチルアンモニウム、ジク 40 ロロ酢酸テトラブチルアンモニウム、トリクロロ酢酸テ トラブチルアンモニウム、トリフルオロ酢酸テトラブチ ルアンモニウム、マロン酸テトラブチルアンモニウム、 スルホン酸テトラブチルアンモニウム、フマル酸テトラ ブチルアンモニウム、酒石酸テトラブチルアンモニウ ム、イタコン酸テトラブチルアンモニウム、メサコン酸 テトラブチルアンモニウム、シトラコン酸テトラブチル アンモニウム、リンゴ酸テトラブチルアンモニウム、グ ルタル酸テトラブチルアンモニウム: 水酸化トリメチル ベンジルアンモニウム、塩化トリメチルベンジルアンモ

(13)

リメチルベンジルアンモニウム、フッ化トリメチルベン ジルアンモニウム、硝酸トリメチルベンジルアンモニウ ム、硫酸トリメチルベンジルアンモニウム、硫酸水素ト リメチルベンジルアンモニウム、リン酸トリメチルベン ジルアンモニウム、炭酸トリメチルベンジルアンモニウ ム、フェノールトリメチルベンジルアンモニウム、酢酸 トリメチルベンジルアンモニウム、アジピン酸トリメチ ルベンジルアンモニウム、アルギン酸トリメチルベンジ ルアンモニウム、安息香酸トリメチルベンジルアンモニ トリメチルベンジルアンモニウム、ギ酸トリメチルベン ジルアンモニウム、炭酸水素トリメチルベンジルアンモ ニウム、フタル酸トリメチルベンジルアンモニウム、サ リチル酸トリメチルベンジルアンモニウム、コハク酸ト リメチルベンジルアンモニウム、マレイン酸トリメチル ベンジルアンモニウム、プロピオン酸トリメチルベンジ ルアンモニウム、ブタン酸トリメチルベンジルアンモニ ウム、ペンタン酸トリメチルベンジルアンモニウム、ヘ キサン酸トリメチルベンジルアンモニウム、ヘプタン酸 ルベンジルアンモニウム、ノナン酸トリメチルベンジル アンモニウム、デカン酸トリメチルベンジルアンモニウ ム、シュウ酸トリメチルベンジルアンモニウム、メチル マロン酸トリメチルベンジルアンモニウム、セバシン酸 トリメチルベンジルアンモニウム、没食子酸トリメチル ベンジルアンモニウム、酪酸トリメチルベンジルアンモ ニウム、メリット酸トリメチルベンジルアンモニウム、 アラキドン酸トリメチルベンジルアンモニウム、シキミ 酸トリメチルベンジルアンモニウム、2-エチルヘキサ ン酸トリメチルベンジルアンモニウム、オレイン酸トリ メチルベンジルアンモニウム、ステアリン酸トリメチル ベンジルアンモニウム、リノール酸トリメチルベンジル アンモニウム、リノレイン酸トリメチルベンジルアンモ ニウム、p-アミノ安息香酸トリメチルベンジルアンモ ニウム、pートルエンスルホン酸トリメチルベンジルア ンモニウム、ベンゼンスルホン酸トリメチルベンジルア ンモニウム、モノクロロ酢酸トリメチルベンジルアンモ ニウム、ジクロロ酢酸トリメチルベンジルアンモニウ ム、トリクロロ酢酸トリメチルベンジルアンモニウム、 トリフルオロ酢酸トリメチルベンジルアンモニウム、マ 40 ロン酸トリメチルベンジルアンモニウム、スルホン酸ト リメチルベンジルアンモニウム、フマル酸トリメチルベ ンジルアンモニウム、酒石酸トリメチルベンジルアンモ ニウム、イタコン酸トリメチルベンジルアンモニウム、 メサコン酸トリメチルベンジルアンモニウム、シトラコ ン酸トリメチルベンジルアンモニウム、リンゴ酸トリメ チルベンジルアンモニウム、グルタル酸トリメチルベン ジルアンモニウム;

【0021】水酸化エタノールアンモニウム、塩化エタ ノールアンモニウム、臭化エタノールアンモニウム、沃 50 ノールアンモニウム、ギ酸ジエタノールアンモニウム、

化エタノールアンモニウム、フッ化エタノールアンモニ ウム、硝酸エタノールアンモニウム、硫酸エタノールア ンモニウム、硫酸水素エタノールアンモニウム、リン酸 エタノールアンモニウム、炭酸エタノールアンモニウ ム、フェノールエタノールアンモニウム、酢酸エタノー ルアンモニウム、アジピン酸エタノールアンモニウム、 アルギン酸エタノールアンモニウム、安息香酸エタノー ルアンモニウム、硫酸エタノールアンモニウム、クエン 酸エタノールアンモニウム、ギ酸エタノールアンモニウ ウム、硫酸トリメチルベンジルアンモニウム、クエン酸 10 ム、炭酸水素エタノールアンモニウム、フタル酸エタノ ールアンモニウム、サリチル酸エタノールアンモニウ ム、コハク酸エタノールアンモニウム、マレイン酸エタ ノールアンモニウム、プロピオン酸エタノールアンモニ ウム、ブタン酸エタノールアンモニウム、ペンタン酸エ タノールアンモニウム、ヘキサン酸エタノールアンモニ ウム、ヘプタン酸エタノールアンモニウム、オクタン酸 エタノールアンモニウム、ノナン酸エタノールアンモニ ウム、デカン酸エタノールアンモニウム、シュウ酸エタ ノールアンモニウム、メチルマロン酸エタノールアンモ トリメチルベンジルアンモニウム、オクタン酸トリメチ 20 ニウム、セバシン酸エタノールアンモニウム、没食子酸 エタノールアンモニウム、酪酸エタノールアンモニウ ム、メリット酸エタノールアンモニウム、アラキドン酸 エタノールアンモニウム、シキミ酸エタノールアンモニ ウム、2-エチルヘキサン酸エタノールアンモニウム、 オレイン酸エタノールアンモニウム、ステアリン酸エタ ノールアンモニウム、リノール酸エタノールアンモニウ ム、リノレイン酸エタノールアンモニウム、p-アミノ 安息香酸エタノールアンモニウム、pートルエンスルホ ン酸エタノールアンモニウム、ベンゼンスルホン酸エタ 30 ノールアンモニウム、モノクロロ酢酸エタノールアンモ ニウム、ジクロロ酢酸エタノールアンモニウム、トリク ロロ酢酸エタノールアンモニウム、トリフルオロ酢酸エ タノールアンモニウム、マロン酸エタノールアンモニウ ム、スルホン酸エタノールアンモニウム、フマル酸エタ ノールアンモニウム、酒石酸エタノールアンモニウム、 イタコン酸エタノールアンモニウム、メサコン酸エタノ ールアンモニウム、シトラコン酸エタノールアンモニウ ム、リンゴ酸エタノールアンモニウム、グルタル酸エタ ノールアンモニウム; 水酸化ジエタノールアンモニウ ム、塩化ジエタノールアンモニウム、臭化ジエタノール アンモニウム、沃化ジエタノールアンモニウム、フッ化 ジエタノールアンモニウム、硝酸ジエタノールアンモニ ウム、硫酸ジエタノールアンモニウム、硫酸水素ジエタ ノールアンモニウム、リン酸ジエタノールアンモニウ ム、炭酸ジエタノールアンモニウム、フェノールジエタ ノールアンモニウム、酢酸ジエタノールアンモニウム、 アジピン酸ジエタノールアンモニウム、アルギン酸ジエ タノールアンモニウム、安息香酸ジエタノールアンモニ ウム、硫酸ジエタノールアンモニウム、クエン酸ジエタ

炭酸水素ジエタノールアンモニウム、フタル酸ジエタノ ールアンモニウム、サリチル酸ジエタノールアンモニウ ム、コハク酸ジエタノールアンモニウム、マレイン酸ジ エタノールアンモニウム、プロピオン酸ジエタノールア ンモニウム、ブタン酸ジエタノールアンモニウム、ペン タン酸ジエタノールアンモニウム、ヘキサン酸ジエタノ ールアンモニウム、ヘプタン酸ジエタノールアンモニウ ム、オクタン酸ジエタノールアンモニウム、ノナン酸ジ エタノールアンモニウム、デカン酸ジエタノールアンモ ニウム、シュウ酸ジエタノールアンモニウム、メチルマ ロン酸ジエタノールアンモニウム、セバシン酸ジエタノ ールアンモニウム、没食子酸ジエタノールアンモニウ ム、酪酸ジエタノールアンモニウム、メリット酸ジエタ ノールアンモニウム、アラキドン酸ジエタノールアンモ . ニウム、シキミ酸ジエタノールアンモニウム、2-エチ ルヘキサン酸ジエタノールアンモニウム、オレイン酸ジ エタノールアンモニウム、ステアリン酸ジエタノールア ンモニウム、リノール酸ジエタノールアンモニウム、リ ノレイン酸ジエタノールアンモニウム、p-アミノ安息 酸ジエタノールアンモニウム、ベンゼンスルホン酸ジェ タノールアンモニウム、モノクロロ酢酸ジエタノールア ンモニウム、ジクロロ酢酸ジエタノールアンモニウム、 トリクロロ酢酸ジエタノールアンモニウム、トリフルオ ロ酢酸ジエタノールアンモニウム、マロン酸ジエタノー ルアンモニウム、スルホン酸ジエタノールアンモニウ ム、フマル酸ジエタノールアンモニウム、酒石酸ジエタ ノールアンモニウム、イタコン酸ジエタノールアンモニ ウム、メサコン酸ジエタノールアンモニウム、シトラコ アンモニウム、グルタル酸ジエタノールアンモニウム; 水酸化トリエタノールアンモニウム、塩化トリエタノー ルアンモニウム、臭化トリエタノールアンモニウム、沃 化トリエタノールアンモニウム、フッ化トリエタノール アンモニウム、硝酸トリエタノールアンモニウム、硫酸 トリエタノールアンモニウム、硫酸水素トリエタノール アンモニウム、リン酸トリエタノールアンモニウム、炭 酸トリエダノールアンモニウム、フェノールトリエタノ ールアンモニウム、酢酸トリエタノールアンモニウム、 アジピン酸トリエタノールアンモニウム、アルギン酸ト リエタノールアンモニウム、安息香酸トリエタノールア ンモニウム、硫酸トリエタノールアンモニウム、クエン 酸トリエタノールアンモニウム、ギ酸トリエタノールア ンモニウム、炭酸水素トリエタノールアンモニウム、フ タル酸トリエタノールアンモニウム、サリチル酸トリエ タノールアンモニウム、コハク酸トリエタノールアンモ ニウム、マレイン酸トリエタノールアンモニウム、プロ ピオン酸トリエタノールアンモニウム、ブタン酸トリエ タノールアンモニウム、ペンタン酸トリエタノールアン モニウム、ヘキサン酸トリエタノールアンモニウム、ヘ 50 ロロ酢酸ピリジニウム、トリクロロ酢酸ピリジニウム、

プタン酸トリエタノールアンモニウム、オクタン酸トリ エタノールアンモニウム、ノナン酸トリエタノールアン モニウム、デカン酸トリエタノールアンモニウム、シュ ウ酸トリエタノールアンモニウム、メチルマロン酸トリ エタノールアンモニウム、セバシン酸トリエタノールア ンモニウム、没食子酸トリエタノールアンモニウム、酪 酸トリエタノールアンモニウム、メリット酸トリエタノ ールアンモニウム、アラキドン酸トリエタノールアンモ ニウム、シキミ酸トリエタノールアンモニウム、2-エ 10 チルヘキサン酸トリエタノールアンモニウム、オレイン 酸トリエタノールアンモニウム、ステアリン酸トリエタ ノールアンモニウム、リノール酸トリエタノールアンモ ニウム、リノレイン酸トリエタノールアンモニウム、p ·ーアミノ安息香酸トリエタノールアンモニウム、pート ルエンスルホン酸トリエタノールアンモニウム、ベンゼ ンスルホン酸トリエタノールアンモニウム、モノクロロ 酢酸トリエタノールアンモニウム、ジクロロ酢酸トリエ タノールアンモニウム、トリクロロ酢酸トリエタノール アンモニウム、トリフルオロ酢酸トリエタノールアンモ 香酸ジエタノールアンモニウム、p-トルエンスルホン 20 ニウム、マロン酸トリエタノールアンモニウム、スルホ ン酸トリエタノールアンモニウム、フマル酸トリエタノ ールアンモニウム、酒石酸トリエタノールアンモニウ ム、イタコン酸トリエタノールアンモニウム、メサコン 酸トリエタノールアンモニウム、シトラコン酸トリエタ ノールアンモニウム、リンゴ酸トリエタノールアンモニ ウム、グルタル酸トリエタノールアンモニウム;一般式 (5)で表される化合物としては、水酸化ピリジニウ ム、塩化ピリジニウム、臭化ピリジニウム、沃化ピリジ ニウム、フッ化ピリジニウム、硝酸ピリジニウム、硫酸 ン酸ジエタノールアンモニウム、リンゴ酸ジエタノール 30 ピリジニウム、硫酸水素ピリジニウム、リン酸ピリジニ ウム、炭酸ピリジニウム、フェノールピリジニウム、酢 酸ピリジニウム、アジピン酸ピリジニウム、アルギン酸 ピリジニウム、安息香酸ピリジニウム、硫酸ピリジニウ ム、クエン酸ピリジニウム、ギ酸ピリジニウム、炭酸水 素ピリジニウム、フタル酸ピリジニウム、サリチル酸ピ リジニウム、コハク酸ピリジニウム、マレイン酸ピリジ ニウム、プロピオン酸ピリジニウム、ブタン酸ピリジニ ウム、ペンタン酸ピリジニウム、ヘキサン酸ピリジニウ ム、ヘプタン酸ピリジニウム、オクタン酸ピリジニウ 40 ム、ノナン酸ピリジニウム、デカン酸ピリジニウム、シ ュウ酸ピリジニウム、メチルマロン酸ピリジニウム、セ バシン酸ピリジニウム、没食子酸ピリジニウム、酪酸ピ リジニウム、メリット酸ピリジニウム、アラキドン酸ピ リジニウム、シキミ酸ピリジニウム、2-エチルヘキサ・ ン酸ピリジニウム、オレイン酸ピリジニウム、ステアリ ン酸ピリジニウム、リノール酸ピリジニウム、リノレイ ン酸ピリジニウム、pーアミノ安息香酸ピリジニウム、 p-トルエンスルホン酸ピリジニウム、ベンゼンスルホ ン酸ピリジニウム、モノクロロ酢酸ピリジニウム、ジク

トリフルオロ酢酸ピリジニウム、マロン酸ピリジニウ ム、スルホン酸ピリジニウム、フマル酸ピリジニウム、 酒石酸ピリジニウム、イタコン酸ピリジニウム、メサコ ン酸ピリジニウム、シトラコン酸ピリジニウム、リンゴ 酸ピリジニウム、グルタル酸ピリジニウム; 水酸化キノ リニウム、塩化キノリニウム、臭化キノリニウム、沃化 キノリニウム、フッ化キノリニウム、硝酸キノリニウ ム、硫酸キノリニウム、硫酸水素キノリニウム、リン酸 キノリニウム、炭酸キノリニウム、フェノールキノリニ ルギン酸キノリニウム、安息香酸キノリニウム、硫酸キ ノリニウム、クエン酸キノリニウム、ギ酸キノリニウ ム、炭酸水素キノリニウム、フタル酸キノリニウム、サ リチル酸キノリニウム、コハク酸キノリニウム、マレイ ン酸キノリニウム、プロピオン酸キノリニウム、ブタン 酸キノリニウム、ペンタン酸キノリニウム、ヘキサン酸 キノリニウム、ヘプタン酸キノリニウム、オクタン酸キ ノリニウム、ノナン酸キノリニウム、デカン酸キノリニ ウム、シュウ酸キノリニウム、メチルマロン酸キノリニ ウム、セバシン酸キノリニウム、没食子酸キノリニウ ム、酪酸キノリニウム、メリット酸キノリニウム、アラ キドン酸キノリニウム、シキミ酸キノリニウム、2-エ チルヘキサン酸キノリニウム、オレイン酸キノリニウ ム、ステアリン酸キノリニウム、リノール酸キノリニウ ム、リノレイン酸キノリニウム、p-アミノ安息香酸キ ノリニウム、pートルエンスルホン酸キノリニウム、ベ ンゼンスルホン酸キノリニウム、モノクロロ酢酸キノリ ニウム、ジクロロ酢酸キノリニウム、トリクロロ酢酸キ ノリニウム、トリフルオロ酢酸キノリニウム、マロン酸 キノリニウム、スルホン酸キノリニウム、フマル酸キノ リニウム、酒石酸キノリニウム、イタコン酸キノリニウ ム、メサコン酸キノリニウム、シトラコン酸キノリニウ ム、リンゴ酸キノリニウム、グルタル酸キノリニウム: 水酸化ピペリジニウム、塩化ピペリジニウム、臭化ピペ リジニウム、沃化ピペリジニウム、フッ化ピペリジニウ ム、硝酸ピペリジニウム、硫酸ピペリジニウム、硫酸水 素ピペリジニウム、リン酸ピペリジニウム、炭酸ピペリ ジニウム、フェノールピペリジニウム、酢酸ピペリジニ ウム、アジピン酸ピペリジニウム、アルギン酸ピペリジ ニウム、安息香酸ピペリジニウム、硫酸ピペリジニウ ム、クエン酸ピペリジニウム、ギ酸ピペリジニウム、炭 酸水素ピペリジニウム、フタル酸ピペリジニウム、サリ チル酸ピペリジニウム、コハク酸ピペリジニウム、マレ イン酸ピペリジニウム、プロピオン酸ピペリジニウム、 ブタン酸ピペリジニウム、ペンタン酸ピペリジニウム、 ヘキサン酸ピペリジニウム、ヘプタン酸ピペリジニウ ム、オクタン酸ピペリジニウム、ノナン酸ピペリジニウ ム、デカン酸ピペリジニウム、シュウ酸ピペリジニウ ム、メチルマロン酸ピペリジニウム、セバシン酸ピペリ ジニウム、没食子酸ピペリジニウム、酪酸ピペリジニウ 50 酸塩、ジアザビシクロオクタンマレイン酸塩、ジアザビ

ム、メリット酸ピペリジニウム、アラキドン酸ピペリジ ニウム、シキミ酸ピペリジニウム、2-エチルヘキサン 酸ピペリジニウム、オレイン酸ピペリジニウム、ステア リン酸ピペリジニウム、リノール酸ピペリジニウム、リ ノレイン酸ピペリジニウム、p-アミノ安息香酸ピペリ ジニウム、p-トルエンスルホン酸ピペリジニウム、ベ ンゼンスルホン酸ピペリジニウム、モノクロロ酢酸ピペ リジニウム、ジクロロ酢酸ピペリジニウム、トリクロロ 酢酸ピペリジニウム、トリフルオロ酢酸ピペリジニウ ウム、酢酸キノリニウム、アジピン酸キノリニウム、ア 10 ム、マロン酸ピペリジニウム、スルホン酸ピペリジニウ ム、フマル酸ピペリジニウム、酒石酸ピペリジニウム、 イタコン酸ピペリジニウム、メサコン酸ピペリジニウ ム、シトラコン酸ピペリジニウム、リンゴ酸ピペリジニ ウム、グルタル酸ピペリジニウム;水酸化ピペラジニウ ム、塩化ピペラジニウム、臭化ピペラジニウム、沃化ピ ペラジニウム、フッ化ピペラジニウム、硝酸ピペラジニ ウム、硫酸ピペラジニウム、硫酸水素ピペラジニウム、 リン酸ピペラジニウム、炭酸ピペラジニウム、フェノー ルピペラジニウム、酢酸ピペラジニウム、アジピン酸ピ 20 ペラジニウム、アルギン酸ピペラジニウム、安息香酸ピ ペラジニウム、硫酸ピペラジニウム、クエン酸ピペラジ ニウム、ギ酸ピペラジニウム、炭酸水素ピペラジニウ ム、フタル酸ピペラジニウム、サリチル酸ピペラジニウ ム、コハク酸ピペラジニウム、マレイン酸ピペラジニウ ム、プロピオン酸ピペラジニウム、ブタン酸ピペラジニ ウム、ペンタン酸ピペラジニウム、ヘキサン酸ピペラジ ニウム、ヘプタン酸ピペラジニウム、オクタン酸ピペラ ジニウム、ノナン酸ピペラジニウム、デカン酸ピペラジ ニウム、シュウ酸ピペラジニウム、メチルマロン酸ピペ 30 ラジニウム、セバシン酸ピペラジニウム、没食子酸ピペ ラジニウム、酪酸ピペラジニウム、メリット酸ピペラジ ニウム、アラキドン酸ピペラジニウム、シキミ酸ピペラ・ ジニウム、2-エチルヘキサン酸ピペラジニウム、オレ イン酸ピペラジニウム、ステアリン酸ピペラジニウム、 リノール酸ピペラジニウム、リノレイン酸ピペラジニウ ム、p-アミノ安息香酸ピペラジニウム、p-トルエン スルホン酸ピペラジニウム、ベンゼンスルホン酸ピペラ ジニウム、モノクロロ酢酸ピペラジニウム、ジクロロ酢 酸ピペラジニウム、トリクロロ酢酸ピペラジニウム、ト 40 リフルオロ酢酸ピペラジニウム、マロン酸ピペラジニウ ム、スルホン酸ピペラジニウム、フマル酸ピペラジニウ ム、酒石酸ピペラジニウム、イタコン酸ピペラジニウ ム、メサコン酸ピペラジニウム、シトラコン酸ピペラジ ニウム、リンゴ酸ピペラジニウム、グルタル酸ピペラジ ニウム;ジアザビシクロオクタン塩酸塩、ジアザビシク ロオクタン臭酸塩、ジアザビシクロオクタン硝酸塩、ジ アザビシクロオクタン硫酸塩、ジアザビシクロオクタン 硫酸水素塩、ジアザビシクロオクタン炭酸塩、ジアザビ シクロオクタン炭酸水素塩、ジアザビシクロオクタン酢

シクロオクタンフタル酸塩、ジアザビシクロオクタンシ ュウ酸塩、ジアザビシクロオクタンイタコン酸塩、ジア ザビシクロオクタンマロン酸塩、ジアザビシクロオクタ ンギ酸塩、ジアザビシクロオクタン酪酸塩、ジアザビシ クロオクタンリンゴ酸塩、ジアザビシクロノナン塩酸 塩、ジアザビシクロノナン臭酸塩、ジアザビシクロノナ ン硝酸塩、ジアザビシクロノナン硫酸塩、ジアザビシク ロノナン硫酸水素塩、ジアザビシクロノナン炭酸塩、ジ アザビシクロノナン炭酸水素塩、ジアザビシクロノナン 酢酸塩、ジアザビシクロノナンマレイン酸塩、ジアザビ 10 シクロノナンフタル酸塩、ジアザビシクロノナンシュウ 酸塩、ジアザビシクロノナンイタコン酸塩、ジアザビシ クロノナンマロン酸塩、ジアザビシクロノナンギ酸塩、 ジアザビシクロノナン酪酸塩、ジアザビシクロノナンリ ンゴ酸塩、ジアザビシクロウンデセン塩酸塩、ジアザビ シクロウンデセン臭酸塩、ジアザビシクロウンデセン硝 酸塩、ジアザビシクロウンデセン硫酸塩、ジアザビシク ロウンデセン硫酸水素塩、ジアザビシクロウンデセン炭 酸塩、ジアザビシクロウンデセン炭酸水素塩、ジアザビ シクロウンデセン酢酸塩、ジアザビシクロウンデセンマ 20 レイン酸塩、ジアザビシクロウンデセンフタル酸塩、ジ アザビシクロウンデセンシュウ酸塩、ジアザビシクロウ ンデセンイタコン酸塩、ジアザビシクロウンデセンマロ ン酸塩、ジアザビシクロウンデセンギ酸塩、ジアザビシ クロウンデセン酪酸塩、ジアザビシクロウンデセンリン ゴ酸塩などを挙げることができる。これらの中で、水酸 化窒素オニウム塩化合物とカルボン酸窒素オニウム塩化 合物を好ましい例として挙げることができ、水酸化アン モニウム化合物とカルボン酸アンモニウム塩化合物が特 に好ましい。これらの(B)成分は、1種あるいは2種 30 以上を同時に使用してもよい。

【0022】上記(B)成分の使用量は、化合物(1)~(3)中のR'O-基,R'O-基,R'O-基およびR'O-基で表される基の総量1モルに対して、通常、0.00001~1モル、好ましくは0.0005~0.5モルである。(B)成分の使用量が上記範囲内であれば、反応中のポリマーの析出やゲル化の恐れが少ない。なお、上記(A)成分を加水分解、縮合させる際に、(A)成分1モル当たり0.5~150モルの

(C) 水を用いることが好ましく、0.5~130モルの水を加えることが特に好ましい。添加する水の量が0.5モル未満であると塗膜の耐クラック性が劣る場合があり、150モルを越えると加水分解および縮合反応中のポリマーの析出やゲル化が生じる場合がある。本発明の(A)成分の加水分解時に使用する(D)沸点100℃以下のアルコールとしては、例えばメタノール、エタノール、nープロパノール、イソプロパノールを挙げることができる。沸点100℃以下のアルコールの使用量は、(A)成分1モルに対して通常3~100モル、好ましくは5~80モルである。(A)成分を加水分解

する際の濃度としては $0.5 \sim 10\%$ (完全加水分解縮合物換算)であり、より好ましくは $1 \sim 8\%$ である。また、この際の反応温度としては、通常、 $0 \sim 100\%$ 、好ましくは $15 \sim 90\%$ である。

【0023】本発明の膜形成用組成物の具体的な製造方法としては、例えば、(D)成分と(E)成分中化合物(1)~(3)を混合して、水を連続的または断続的に添加して、加水分解し、縮合すればよく、特に限定されないが、下記1)~11)の方法などを挙げることができる。

- 1) (A) 成分を構成する化合物(1)~(3)、
- (B) 成分、(C) 成分および(C) 成分からなる混合物に、所定量の水を加えて、加水分解・縮合反応を行う方法。
- 2) (A) 成分を構成する化合物(1)~(3)、
- (B)成分、(D)成分からなる混合物に、所定量の水 を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解、縮合反 応を行う方法。
- 3) (A) 成分を構成する化合物(1)~(3)、
- (D) 成分からなる混合物に、所定量の水および (B) 成分を加えて、加水分解・縮合反応を行う方法。
- 4) (A) 成分を構成する化合物 (1) ~ (3)、
- (D) 成分からなる混合物に、所定量の水および(B) 成分を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解、縮合反応を行う方法。
- 5) (D)成分、水および(B)成分からなる混合物に、所定量の(A)成分を構成する化合物(1)~
- (3)を加えて、加水分解・縮合反応を行う方法。
- 6) (D) 成分、水および (B) 成分からなる混合物 に、所定量の (A) 成分を構成する化合物 (1) ~
- (3) を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解・ 縮合反応を行う方法。
- 7) (D) 成分、水および (B) 成分からなる混合物に、所定量の (A) 成分を構成する化合物 (1) ~
- (3) を加えて、加水分解・縮合反応を行い、p H調整 剤を添加する方法。
- 8) (D) 成分、水および(B) 成分からなる混合物に、所定量の(A) 成分を構成する化合物(1)~
- (3) を加えて、加水分解・縮合反応を行い、溶液の一 40 定濃度に濃縮した後pH調整剤を添加する方法。
 - 9) 上記1)~8) の方法で得られた溶液を、有機溶剤で抽出する方法。
 - 10)上記1)~8)の方法で得られた溶液を、有機溶剤で置換する方法。
 - 11)上記1)~8)の方法で得られた溶液を、有機溶剤で抽出した後、別な有機溶剤で置換する方法。

る。加水分解縮合物の慣性半径が4~50nmである と、得られるシリカ系膜の比誘電率、弾性率および膜の 均一性に特に優れるものとできる。また、このようにし て得られる(A)加水分解縮合物は、粒子状の形態をと っていないことにより、基板状への塗布性が優れるとい う特徴を有している。粒子状の形態をとっていないこと は、例えば透過型電子顕微鏡観察(TEM)により確認 される。

【0024】さらに、(A)成分のを加水分解、縮合し 好ましい。pHを調整する方法としては、

①p H調整剤を添加する方法、

②常圧または減圧下で、組成物中より(B)成分を留去 する方法、

③窒素、アルゴンなどのガスをバブリングすることによ り、組成物中から(B)成分を除去する方法、

④イオン交換樹脂により、組成物中から(B)成分を除 く方法、

⑤抽出や洗浄によって(B)成分を系外に除去する方 法、

などが挙げられる。これらの方法は、それぞれ、組み合 わせて用いてもよい。

【0025】ここで、上記pH調整剤としては、無機酸 や有機酸が挙げられる。無機酸としては、例えば、塩 酸、硝酸、硫酸、フッ酸、リン酸、ホウ酸、シュウ酸な どを挙げることができる。また、有機酸としては、例え ば、酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキ サン酸、ヘプタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン 酸、シュウ酸、マレイン酸、メチルマロン酸、アジピン ドン酸、シキミ酸、2-エチルヘキサン酸、オレイン 酸、ステアリン酸、リノール酸、リノレイン酸、サリチ ル酸、安息香酸、pーアミノ安息香酸、pートルエンス ルホン酸、ベンゼンスルホン酸、モノクロロ酢酸、ジク ロロ酢酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸、 マロン酸、スルホン酸、フタル酸、フマル酸、クエン 酸、酒石酸、コハク酸、フマル酸、イタコン酸、メサコ ン酸、シトラコン酸、リンゴ酸、グルタル酸の加水分解 物、無水マレイン酸の加水分解物、無水フタル酸の加水 分解物などを挙げることができる。これら化合物は、1 種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0026】上記pH調整剤による組成物のpHは、7 以下、好ましくは1~6に調整される。このように、加 水分解縮合物の慣性半径を4~50nmとなしたのち、 上記pH調整剤により上記範囲内にpHを調整すること により、得られる組成物の貯蔵安定性が向上するという 効果が得られる。pH調整剤の使用量は、組成物のpH が上記範囲内となる量であり、その使用量は、適宜選択 される。

【0027】上記の製造方法9)~11)で使用する有 50 ルケトン、メチルーnーペンチルケトン、エチルーnー

機溶媒としては、アルコール系溶媒、ケトン系溶媒、ア ミド系溶媒、エステル系溶媒および非プロトン系溶媒の 群から選ばれた少なくとも1種が挙げられる。ここで、 アルコール系溶媒としては、メタノール、エタノール、 nープロパノール、iープロパノール、nーブタノー ル、iーブタノール、secーブタノール、tーブタノ ール、nーペンタノール、iーペンタノール、2ーメチ ルブタノール、secーペンタノール、tーペンタノー ル、3-メトキシブタノール、n-ヘキサノール、2-た後、膜形成用組成物のpHを7以下に調整することが 10 メチルペンタノール、secーヘキサノール、2-エチ ルブタノール、secーヘプタノール、ヘプタノールー 3、n-オクタノール、2-エチルヘキサノール、se c-オクタノール、n-ノニルアルコール、2,6-ジ メチルヘプタノールー4、nーデカノール、sec-ウ ンデシルアルコール、トリメチルノニルアルコール、s ecーテトラデシルアルコール、secーヘプタデシル アルコール、フェノール、シクロヘキサノール、メチル シクロヘキサノール、3,3,5-トリメチルシクロヘ キサノール、ベンジルアルコール、ジアセトンアルコー・ 20 ルなどのモノアルコール系溶媒:

【0028】エチレングリコール、1,2-プロピレン グリコール、1,3ープチレングリコール、ペンタンジ オールー2, 4、2ーメチルペンタンジオールー2, 4、ヘキサンジオールー2,5、ヘプタンジオールー 2, 4、2-エチルヘキサンジオール-1, 3、ジェチ レングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチレ ングリコール、トリプロピレングリコールなどの多価ア ルコール系溶媒;エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレン 酸、セバシン酸、没食子酸、酪酸、メリット酸、アラキ 30 グリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコール モノブチルエーテル、エチレングリコールモノヘキシル エーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、 エチレングリコールモノー2ーエチルプチルエーテル、 ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレン グリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコール モノプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチ ルエーテル、ジェチレングリコールモノヘキシルエーテ ル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピ レングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコ 40 ールモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノ ブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエ ーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、 ジプロピレングリコールモノプロピルエーテルなどの多 価アルコール部分エーテル系溶媒;などを挙げることが できる。これらのアルコール系溶媒は、1種あるいは2 種以上を同時に使用してもよい。

> 【0029】ケトン系溶媒としては、アセトン、メチル エチルケトン、メチルーnープロピルケトン、メチルー nープチルケトン、ジエチルケトン、メチルーiープチ

プチルケトン、メチルーn-ヘキシルケトン、ジーi-プチルケトン、トリメチルノナノン、シクロヘキサノ ン、2-ヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、2.4 ーペンタンジオン、アセトニルアセトン、アセトフェノ ン、フェンチョンなどのほか、アセチルアセトン、2. 4-ヘキサンジオン、2, 4-ヘプタンジオン、3.5 ーヘプタンジオン、2、4ーオクタンジオン、3、5ー オクタンジオン、2, 4ーノナンジオン、3, 5ーノナ ンジオン、5-メチル-2, 4-ヘキサンジオン、2、 1, 1, 1, 5, 5, 5ーヘキサフルオロー2, 4ーヘ プタンジオンなどのβージケトン類などが挙げられる。 これらのケトン系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時 に使用してもよい。

【0030】アミド系溶媒としては、ホルムアミド、N ーメチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミ ド、N-エチルホルムアミド、N, N-ジエチルホルム アミド、アセトアミド、Nーメチルアセトアミド、N. N-ジメチルアセトアミド、N-エチルアセトアミド、 アミド、Nーメチルピロリドン、Nーホルミルモルホリ . ン、Nーホルミルピペリジン、Nーホルミルピロリジ ン、Nーアセチルモルホリン、Nーアセチルピペリジ ン、Nーアセチルピロリジンなどが挙げられる。これら アミド系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用し てもよい。

【0031】エステル系溶媒としては、ジエチルカーボ ネート、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸ジエチ ル、酢酸メチル、酢酸エチル、γープチロラクトン、γ ーバレロラクトン、酢酸nープロピル、酢酸iープロピ ル、酢酸n-ブチル、酢酸i-ブチル、酢酸sec-ブ チル、酢酸n-ペンチル、酢酸sec-ペンチル、酢酸 3-メトキシブチル、酢酸メチルペンチル、酢酸2-エ R" O (CHCH, CH, O), R"

(R"およびR"は、それぞれ独立して水素原子、炭素 数1~4のアルキル基またはCH,CO-から選ばれる 1価の有機基を示し、gは1~2の整数を表す。) 以上の有機溶媒は、1種あるいは2種以上を混合して使 用することができる。

【0033】その他の添加剤

本発明で得られる膜形成用組成物には、さらにコロイド 状シリカ、コロイド状アルミナ、有機ポリマー、界面活 性剤、シランカップリング剤、ラジカル発生剤、トリア ゼン化合物などの成分を添加してもよい。コロイド状シ リカとは、例えば、高純度の無水ケイ酸を前記親水性有 機溶媒に分散した分散液であり、通常、平均粒径が5~ 30m μ、好ましくは10~20m μ、固形分濃度が1 0~40重量%程度のものである。このような、コロイ ド状シリカとしては、例えば、日産化学工業(株)製、

チルブチル、酢酸2-エチルヘキシル、酢酸ペンジル、 酢酸シクロヘキシル、酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸 n-ノニル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、酢 酸エチレングリコールモノメチルエーテル、酢酸エチレ ングリコールモノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリ コールモノメチルエーテル、酢酸ジエチレングリコール モノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノー nーブチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノメ チルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノエチルエ 10 ーテル、酢酸プロピレングリコールモノプロピルエーテ ル、酢酸プロピレングリコールモノブチルエーテル、酢 酸ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸ジ プロピレングリコールモノエチルエーテル、ジ酢酸グリ コール、酢酸メトキシトリグリコール、プロピオン酸エ チル、プロピオン酸nーブチル、プロピオン酸iーアミ ル、シュウ酸ジエチル、シュウ酸ジーnーブチル、乳酸 メチル、乳酸エチル、乳酸nープチル、乳酸nーアミ ル、マロン酸ジエチル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジ エチルなどが挙げられる。これらエステル系溶媒は、1 N. N-ジエチルアセトアミド、N-メチルプロピオン 20 種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。非プロト ン系溶媒としては、アセトニトリル、ジメチルスルホキ シド、N, N, N´, N´ーテトラエチルスルファミ ド、ヘキサメチルリン酸トリアミド、N-メチルモルホ ロン、N-メチルピロール、N-エチルピロール、N-メチルーΔ3 -ピロリン、N-メチルピペリジン、N-エチルピペリジン、N, N-ジメチルピペラジン、N-メチルイミダゾール、N-メチル-4-ピペリドン、N ーメチル-2-ピペリドン、N-メチル-2-ピロリド ン、1, 3-ジメチル-2-イミダゾリジノン、<math>1, 330 ージメチルテトラヒドロー2 (1H) ーピリミジノンな どを挙げることができる。

> 【0032】これらの有機溶剤の中で、特に下記一般式 (6) で表される溶剤を使用することが好ましい。 $\cdots (6)$

ル;触媒化成工業(株)製、オスカルなどが挙げられ る。コロイド状アルミナとしては、日産化学工業(株) 製のアルミナゾル520、同100、同200:川研フ ァインケミカル(株)製のアルミナクリアーゾル、アル ミナゾル10、同132などが挙げられる。有機ポリマ 40 一としては、例えば、糖鎖構造を有する化合物、ビニル アミド系重合体、 (メタ) アクリル系重合体、芳香族ビ ニル化合物、デンドリマー、ポリイミド、ポリアミック 酸、ポリアリーレン、ポリアミド、ポリキノキサリン、 ポリオキサジアゾール、フッ素系重合体、ポリアルキレ ンオキサイド構造を有する化合物などを挙げることがで

【0034】ポリアルキレンオキサイド構造を有する化 合物としては、ポリメチレンオキサイド構造、ポリエチ レンオキサイド構造、ポリプロピレンオキサイド構造、

メタノールシリカゾルおよびイソプロパノールシリカゾ 50 ポリテトラメチレンオキサイド構造、ポリブチレンオキ

シド構造などが挙げられる。具体的には、ポリオキシメ チレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキル エーテル、ポリオキシエテチレンアルキルフェニルエー テル、ポリオキシエチレンステロールエーテル、ポリオ キシエチレンラノリン誘導体、アルキルフェノールホル マリン縮合物の酸化エチレン誘導体、ポリオキシエチレ ンポリオキシプロピレンブロックコポリマー、ポリオキ シエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルなど のエーテル型化合物、ポリオキシエチレングリセリン脂 肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エ

35

ステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステ ル、ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド硫酸 塩などのエーテルエステル型化合物、ポリエチレングリ コール脂肪酸エステル、エチレングリコール脂肪酸エス テル、脂肪酸モノグリセリド、ポリグリセリン脂肪酸エ ステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコ ール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルなどのエー テルエステル型化合物などを挙げることができる。ポリ オキシチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマー としては下記のようなブロック構造を有する化合物が挙 20 げられる。

-(X) j - (Y) k -

-(X) j - (Y) k - (X) 1-

(式中、Xは-CH₂CH₂O-で表される基を、Yは-CH, CH (CH,) O-で表される基を示し、jは1~ 90、kは10~99、lは0~90の数を示す) これらの中で、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、 ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックコポ リマー、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアル キルエーテル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エ ステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステ ル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、 などのエーテル型化合物をより好ましい例として挙げる ことができる。これらは1種あるいは2種以上を同時に 使用しても良い。

【0035】界面活性剤としては、例えば、ノニオン系 界面活性剤、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活 性剤、両性界面活性剤などが挙げられ、さらには、フッ 素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤、ポリアルキ レンオキシド系界面活性剤、ポリ(メタ)アクリレート 40 系界面活性剤などを挙げることができ、好ましくはフッ 素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤を挙げること ができる。

【0036】フッ素系界面活性剤としては、例えば1, 1, 2, 2-テトラフロロオクチル (1, 1, 2, 2-テトラフロロプロピル) エーテル、1, 1, 2, 2-テ トラフロロオクチルヘキシルエーテル、オクタエチレン グリコールジ (1, 1, 2, 2-テトラフロロブチル) エーテル、ヘキサエチレングリコール(1, 1, 2,

プロピレングリコールジ(1, 1, 2, 2-テトラフロ ロブチル) エーテル、ヘキサプロピレングリコールジ (1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロペンチル) エ ーテル、パーフロロドデシルスルホン酸ナトリウム、 1, 1, 2, 2, 8, 8, 9, 9, 10, 10ーデカフ ロロドデカン、1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロ デカン、N-[3-(パーフルオロオクタンスルホンア ミド) プロピル]-N, N '-ジメチル-N-カルボキ シメチレンアンモニウムベタイン、パーフルオロアルキ 10 ルスルホンアミドプロピルトリメチルアンモニウム塩、 パーフルオロアルキルーN-エチルスルホニルグリシン 塩、リン酸ビス(N-パーフルオロオクチルスルホニル -N-エチルアミノエチル)、モノパーフルオロアルキ ルエチルリン酸エステル等の末端、主鎖および側鎖の少 なくとも何れかの部位にフルオロアルキルまたはフルオ ロアルキレン基を有する化合物からなるフッ素系界面活 性剤を挙げることができる。また、市販品としてはメガ ファックF142D、同F172、同F173、同F1 83 (以上、大日本インキ化学工業(株)製)、エフト ップEF301、同303、同352 (新秋田化成 (株) 製)、フロラードFC-430、同FC-431 (住友スリーエム (株) 製)、アサヒガードAG71 0、サーフロンS-382、同SC-101、同SC-102、同SC-103、同SC-104、同SC-1 05、同SC-106(旭硝子(株)製)、BM-10

00、BM-1100(裕商(株) 製)、NBX-15 ((株)ネオス)などの名称で市販されているフッ素系 界面活性剤を挙げることができる。これらの中でも、上 記メガファックF172, BM-1000, BM-11 30 00, NBX-15が特に好ましい。シリコーン系界面 活性剤としては、例えばSH7PA、SH21PA、S H30PA、ST94PA (いずれも東レ・ダウコーニ ング・シリコーン(株)製などを用いることが出来る。 これらの中でも、上記SH28PA、SH30PAが特 に好ましい。

【0037】界面活性剤の使用量は、(A)成分(完全) 加水分解縮合物)に対して通常0.0001~10重量 部である。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用 しても良い。

【0038】シランカップリング剤としては、例えば3 ーグリシジロキシプロピルトリメトキシシラン、3ーア ミノグリシジロキシプロピルトリエトキシシラン、3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、3-グリ シジロキシプロピルメチルジメトキシシラン、1-メタ クリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、3-アミ ノプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルト リエトキシシラン、2-アミノプロピルトリメトキシシ ラン、2-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-(2-アミノエチル) -3-アミノプロピルトリメトキ 2, 3, 3-ヘキサフロロペンチル) エーテル、オクタ 50 シシラン、N-(2-アミノエチル) -3-アミノプロ

ピルメチルジメトキシシラン、3-ウレイドプロピルト リメトキシシラン、3-ウレイドプロピルトリエトキシ シラン、N-エトキシカルボニル-3-アミノプロピル トリメトキシシラン、N-エトキシカルボニル-3-ア ミノプロピルトリエトキシシラン、N-トリエトキシシ リルプロピルトリエチレントリアミン、N-トリエトキ シシリルプロピルトリエチレントリアミン、10-トリ メトキシシリルー1, 4, 7ートリアザデカン、10-トリエトキシシリルー1, 4, 7ートリアザデカン、9 ートリメトキシシリルー3,6-ジアザノニルアセテー ト、9ートリエトキシシリルー3,6ージアザノニルア セテート、Nーベンジルー3ーアミノプロピルトリメト キシシラン、N-ベンジル-3-アミノプロピルトリエ トキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロピルトリ メトキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロピルト リエトキシシラン、N-ビス (オキシエチレン) -3-アミノプロピルトリメトキシシラン、Nービス(オキシ エチレン) -3-アミノプロピルトリエトキシシランな どが挙げられる。これらは1種あるいは2種以上を同時 に使用しても良い。

【0039】ラジカル発生剤としては、例えばイソブチ リルパーオキサイド、 α 、 α ビス (ネオデカノイルパ ーオキシ) ジイソプロピルベンゼン、クミルパーオキシ ネオデカノエート、ジーnプロピルパーオキシジカーボ ネート、ジイソプロピルパーオキシジカーボネート、 1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルパーオキシネオデ カノエート、ビス (4-t-ブチルシクロヘキシル) パ ーオキシジカーボネート、1-シクロヘキシルー1-メ チルエチルパーオキシネオデカノエート、ジー2-エト ヘキシルパーオキシ) ジカーボネート、t-ヘキシルパ ーオキシネオデカノエート、ジメトキブチルパーオキシ ジカーボネート、ジ (3-メチル-3-メトキシブチル パーオキシ)ジカーボネート、tーブチルパーオキシネ オデカノエート、2, 4-ジクロロベンゾイルパーオキ サイド、tーヘキシルパーオキシピバレート、tーブチ ルパーオキシピバレート、3,5,5-トリメチルヘキ サノイルパーオキサイド、オクタノイルパーオキサイ ド、ラウロイルパーオキサイド、ステアロイルパーオキ シ2-エチルヘキサノエート、スクシニックパーオキサ イド、2,5ージメチルー2,5ージ(2-エチルヘキ サノイルパーオキシ) ヘキサン、1-シクロヘキシルー 1-メチルエチルパーオキシ2-エチルヘキサノエー ト、t - ヘキシルパーオキシ2 - エチルヘキサノエー ト、t ープチルパーオキシ2-エチルヘキサノエート、 m-トルオイルアンドベンゾイルパーオキサイド、ベン ソイルパーオキサイド、t-ブチルパーオキシイソブチ レート、ジーtーブチルパーオキシー2-メチルシクロ ヘキサン、1, 1-ビス (tーヘキシルパーオキシ) - 50 (3, 3-ジメチルトリアゼニル) ベンゼン、2, 7-

3, 3, 5ートリメチルシクロヘキサン、1, 1ービス (t-ヘキシルパーオキシ)シクロヘキサン、1,1-ビス(tーブチルパーオキシ)-3,3,5-トリメチ ルシクロヘキサン、1, 1-ビス(t-ブチルパーオキ シ) シクロヘキサン、2, 2-ビス(4, 4-ジ-t-ブチルパーオキシシクロヘキシル)プロパン、1、1-ビス(tーブチルパーオキシ)シクロデカン、tーヘキ シルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、t-ブ チルパーオキシマレイン酸、t-ブチルパーオキシー 10 3, 3, 5-トリメチルヘキサノエート、tープチルパ ーオキシラウレート、2,5ージメチルー2,5ージ (m-トルオイルパーオキシ) ヘキサン、 t ーブチルパ ーオキシイソプロピルモノカーボネート、tープチルパ ーオキシ2-エチルヘキシルモノカーボネート、t-ヘ キシルパーオキシベンゾエート、2,5-ジメチルー 2, 5-ジ (ベンゾイルパーオキシ) ヘキサン、t-ブ チルパーオキシアセテート、2,2-ビス(t-ブチル パーオキシ) ブタン、t-ブチルパーオキシベンソエー ト、n-ブチル-4, 4-ビス(t-ブチルパーオキ シ) バレレート、ジーtープチルパーオキシイソフタレ ート、 α 、 α ビス(t ープチルパーオキシ)ジイソプ ロピルベンゼン、ジクミルパーオキサイド、2、5-ジ メチルー2, 5-ジ (t-ブチルパーオキシ) ヘキサ ン、tーブチルクミルパーオキサイド、ジーtーブチル パーオキサイド、p-メンタンヒドロパーオキサイド、 2, 5-ジメチルー2, 5-ジ(t-ブチルパーオキ シ) ヘキシン-3、ジイソプロピルベンゼンヒドロパー オキサイド、 t ープチルトリメチルシリルパーオキサイ ド、1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルヒドロパーオ キシエチルパーオキシジカーボネート、ジ(2-エチル 30 キサイド、クメンヒドロパーオキサイド、t-ヘキシル ヒドロパーオキサイド、tーブチルヒドロパーオキサイ ド、2,3-ジメチル-2,3-ジフェニルブタン等を・ 挙げることができる。ラジカル発生剤の配合量は、重合 体100重量部に対し、0.1~10重量部が好まし い。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用しても 良い。

【0040】トリアゼン化合物としては、例えば、1, 2-ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニル)ベンゼン、 1, 3-ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニル) ベンゼ サイド、1, 1, 3, 3-テトラメチルプチルパーオキ 40 ン、1, 4-ビス (3, 3-ジメチルトリアゼニル) ベ ンゼン、ビス(3,3-ジメチルトリアゼニルフェニ ル) エーテル、ビス (3, 3-ジメチルトリアゼニルフ ェニル) メタン、ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル フェニル) スルホン、ビス (3, 3-ジメチルトリアゼ ニルフェニル)スルフィド、2、2-ビス[4-(3、 3-ジメチルトリアゼニルフェノキシ)フェニル]-1, 1, 1, 3, 3, 3~ヘキサフルオロプロパン、 2, 2-ビス〔4-(3, 3-ジメチルトリアゼニルフ ェノキシ)フェニル)プロパン、1、3、5ートリス

ビス (3, 3ージメチルトリアゼニル) -9, 9ービス [4-(3, 3-ジメチルトリアゼニル) フェニル] フ ルオレン、2, 7ービス(3, 3ージメチルトリアゼニ ル) -9, 9-ビス [3-メチル-4-(3, 3-ジメ チルトリアゼニル)フェニル]フルオレン、2、7-ビ ス(3,3-ジメチルトリアゼニル)-9,9-ビス [3-フェニルー4-(3, 3-ジメチルトリアゼニ ル) フェニル] フルオレン、2, 7-ビス(3, 3-ジ メチルトリアゼニル) -9, 9-ビス[3-プロペニル -4-(3, 3-ジメチルトリアゼニル)フェニル]フ ルオレン、2, 7ービス(3, 3ージメチルトリアゼニ ル) -9, 9-ビス [3-フルオロ-4-(3, 3-ジ メチルトリアゼニル)フェニル]フルオレン、2、7-ビス (3, 3ージメチルトリアゼニル) -9. 9ービス [3, 5-ジフルオロー4-(3, 3-ジメチルトリア ゼニル) フェニル] フルオレン、2, 7-ビス (3, 3 ージメチルトリアゼニル) -9, 9-ビス [3-トリフ ルオロメチルー4ー(3,3ージメチルトリアゼニル) フェニル] フルオレンなどが挙げられる。これらは1種 あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

【0041】このようにして得られる本発明の組成物の全固形分濃度は、好ましくは、2~30重量%であり、使用目的に応じて適宜調整される。組成物の全固形分濃度が2~30重量%であると、塗膜の膜厚が適当な範囲となり、保存安定性もより優れるものである。なお、この全固形分濃度の調整は、必要であれば、濃縮および上記有機溶剤による希釈によって行われる。本発明の組成物を、シリコンウエハ、SiO.ウエハ、SiNウエハなどの基材に塗布する際には、スピンコート、浸漬法、ロールコート法、スプレー法などの塗装手段が用いられ30る。

【0042】この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回塗りで厚さ0.05~2.5μm程度、2回塗りでは厚さ0.1~5.0μm程度の塗膜を形成することができる。その後、常温で乾燥するか、あるいは80~600℃程度の温度で、通常、5~240分程度加熱して乾燥することにより、ガラス質または巨大高分子の絶縁膜を形成することができる。この際の加熱方法としては、ホットプレート、オーブン、ファーネスなどを使用することが出来、加熱雰囲気としては、大気下、窒素雰囲気、アルゴン雰囲気、真空下、酸素濃度をコントロールした減圧下などで行うことができる。また、電子線や紫外線を照射することによっても塗膜を形成させることができる。また、上記塗膜の硬化速度を制御するため、必要に

応じて、段階的に加熱したり、窒素、空気、酸素、減圧 などの雰囲気を選択することができる。このようにして 得られる本発明のシリカ系膜は、膜密度が、通常、0. 35~1. 2g/cm³、好ましくは0. 4~1. 1g /cm³、さらに好ましくはO.5~1.0g/cm³ である。 膜密度が 0.35 g/c m³ 未満では、 途膜の 機械的強度が低下し、一方、1.2g/cm゚を超える と低比誘電率が得られない。また、本発明のシリカ系膜 は、BJH法による細孔分布測定において、10nm以 10 上の空孔が認められず、微細配線間の層間絶縁膜材料と して好ましい。さらに、本発明のシリカ系膜は、吸水性 が低い点に特徴を有し、例えば、塗膜を127℃、2. 5 a t m、100%RHの環境に1時間放置した場合、 放置後の塗膜のIRスペクトル観察からは塗膜への水の 吸着は認められない。この吸水性は、本発明における膜 形成用組成物に用いられる化合物 (1) のテトラアルコ キシシラン類の量により、調整することができる。さら に、本発明のシリカ系膜の比誘電率は、通常、2.6~

40

【0043】このようにして得られる層間絶縁膜は、塗膜の比誘電率の温度依存性が小さく、PCT後の比誘電率変化が少なく、かつ塗膜の機械的強度に優れることから、LSI、システムLシ、DRAM、SDRAM、RDRAM、D-RDRAMなどの半導体素子用層間絶縁膜やエッチングストッパー膜、半導体素子の表面コート膜などの保護膜、多層レジストを用いた半導体作製工程の中間層、多層配線基板の層間絶縁膜、液晶表示素子用の保護膜や絶縁膜などの用途に有用である。

1. 2、好ましくは2. 5~1. 2、さらに好ましくは

[0044]

20 2.4~1.2である。

【実施例】以下、本発明を実施例を挙げてさらに具体的に説明する。ただし、以下の記載は、本発明の態様例を概括的に示すものであり、特に理由なく、かかる記載により本発明は限定されるものではない。なお、実施例および比較例中の部および%は、特記しない限り、それぞれ重量部および重量%であることを示している。また、各種の評価は、次のようにして行なった。

【0045】慣性半径

下記条件によるゲルパーミエーションクロマトグラフィ40 ー(GPC) (屈折率, 粘度, 光散乱測定) 法により測定した。試料溶液:シラン化合物の加水分解縮合物を、固形分濃度が0.25%となるように、10mMのLiBrを含むメダノールで希釈し、GPC(屈折率, 粘度, 光散乱測定) 用試料溶液とした。

装置: 東ソー (株) 製、GPCシステム モデル GPC-8020 東ソー (株) 製、カラム Alpha5000/3000 ビスコテック社製、粘度検出器および光散乱検出器

キャリア溶液:10mMのLiBrを含むメタノール

イインン体放、IUMMOCIBIを含むメタノール

モデル T-60 デュアルメーター

キャリア送液速度:1ml/min

【0046】比誘電率の温度依存

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて組成物試料を塗布し、ホットプレート上で80℃で2分間、窒素雰囲気200℃で2分間基板を乾燥し、さらに415℃の窒素雰囲気のホットプレートで30分間基板を焼成した。この膜に対して、実施例に示すシリコン化合物による表面処理を行った。得られた膜に対して蒸着法によりアルミニウム電極パターンを形成させ比誘電率測定用サンプルを作成した。該サンプル温度23℃、湿度50%のクリーンルーム内に2週間放置した後、周波数100kHzの周波数で、横河・ヒューレットパッカード(株)製、HP16451B電極およびHP4284AプレシジョンLCRメータを用いてCV法により当該塗膜の23℃および200℃における比誘電率を測定した。

【0047】PCT後の比誘電率

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で80℃で2分間、窒素雰囲気200℃で2分間基板を乾燥し、さらに 20 420℃の真空雰囲気のホットプレートで25分間基板 を焼成した。得られた膜に対して110℃、湿度100 %RH、2気圧の条件でPCTを1時間行い、蒸着法に よりアルミニウム電極パターンを形成させ比誘電率測定 用サンプルを作成した。該サンプルを周波数100kH 2の周波数で、横河・ヒューレットパッカード(株) 製、HP16451B電極およびHP4284Aプレシ ジョンLCRメータを用いてCV法により当該塗膜の比 誘電率を測定した。

【0048】 塗膜の機械的強度(弾性率)

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で80℃で2分間、窒素雰囲気200℃で2分間基板を乾燥し、さらに 420℃の真空雰囲気のホットプレートで25分間基板 を焼成した。得られた膜の弾性率は、ナノインデンター XP(ナノインスツルメント社製)を用いて、連続剛性 測定法により測定した。

【0049】実施例1

石英製セパラブルフラスコに、エタノール471g、イオン交換水237gと25%水酸化テトラメチルアンモ 40 ニウム水溶液17.2gを入れ、均一に攪拌した。この溶液にメチルトリメトキシシラン44.9gとテトラエトキシシラン68.6gの混合物を添加した。溶液を55℃に保ったまま、2時間反応を行った。この溶液に20%マレイン酸水溶液28gとプロピレングリコールモノプロピルエーテル440gを加え、その後、50℃のエバポレーターを用いて溶液を10%(完全加水分解縮合物換算)となるまで濃縮した。この溶液に酢酸エチル300gとイオン交換水300gを添加し、液々抽出を行った。上層の溶液を取り出し、50℃のエバポレータ 50

ーを用いて溶液を10% (完全加水分解縮合物換算)となるまで濃縮し、反応液 ①を得た。このようにして得られた縮合物等の慣性半径は、20.3 nmであった。この溶液を0.2 μm孔径のテフロン (登録商標) 製フィルターでろ過を行い本発明の膜形成用組成物を得た。得られた組成物をスピンコート法でシリコンウエハ上に塗布後焼成することで塗膜を得た。本塗膜の評価結果を表1に示す。

42

10 【0050】実施例2

合成例1において、25%水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液の代わりに25%酢酸アンモニウム水溶液を使用した以外は合成例1と同様にして、反応液②を得た。このようにして得られた縮合物等の慣性半径は、17.5nmであった。この溶液を実施例1と同様にして評価行った。本途膜の評価結果を表1に示す。

【0051】実施例3

合成例1において、25%水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液の代わりに25%マレイン酸テトラメチルアンモニウム水溶液を使用した以外は合成例1と同様にして、反応液③を得た。このようにして得られた縮合物等の慣性半径は、21.3nmであった。この溶液を実施例1と同様にして評価行った。本途膜の評価結果を表1に示す。

【0052】実施例4

合成例1において、25%水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液の代わりに25%酢酸ピリジニウム水溶液を使用した以外は合成例1と同様にして、反応液④を得た。このようにして得られた縮合物等の慣性半径は、1305.3nmであった。この溶液を実施例1と同様にして評価行った。本強膜の評価結果を表1に示す。

【0053】実施例5

合成例1において、25%水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液の代わりに25%ジアザビシクロウンデセン酢酸塩水溶液を使用した以外は合成例1と同様にして、反応液⑤を得た。このようにして得られた縮合物等の慣性半径は、19.7nmであった。この溶液を実施例1と同様にして評価行った。本塗膜の評価結果を表1に示す。

40 【0054】実施例6

合成例1において、25%水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液の代わりに25%塩化テトラメチルアンモニウム水溶液を使用した以外は合成例1と同様にして、反応液⑥を得た。このようにして得られた縮合物等の慣性半径は、18.7nmであった。この溶液を実施例1と同様にして評価行った。本塗膜の評価結果を表1に示す。

【0055】比較例1

300gとイオン交換水300gを添加し、液々抽出を 合成例1において、25%水酸化テトラメチルアンモニ 行った。上層の溶液を取り出し、50℃のエバポレータ 50 ウム水溶液の代わりに25%酢酸水溶液を使用した以外

膜の評価結果を表1に示す。

は合成例1と同様にして、反応液のを得た。このように して得られた縮合物等の慣性半径は、0.2nmであった。この冷冻を実体例1と同様にして駆体による。

[0056]

た。この溶液を実施例1と同様にして評価行った。本塗 【表

【表1】

	反応被	比誘電率の	比誘電率の温度依存性		途膜の
		23°C	200℃	比誘電率	弹性率(GPa)
実施例1	反応被①	2. 21	2. 16	2. 22	5. 8
実施例2	反応液②	2. 33	2.36	2. 35	6. 5
実施例3	反応液③	2. 19	2. 12	2. 23	5. 3
実施例4	反応液④	2. 44	2. 40	2. 46	8. 5
実施例5	反応被⑤	2. 24	2. 19	2. 26	5. 9
実施例6	反応被⑥	2. 28	2. 24	2. 29	6. 1
比較例1	反応被⑦	3.04	2.60	3. 45	4. 6

[0057]

【発明の効果】本発明によれば、窒素オニウム塩化合物、沸点100℃以下のアルコール、水の存在下アルコキシシラン加水分解および/または縮合を行うことで、

並膜の比誘電率の温度依存性が小さく、PCT後の比誘電率変化が少なく、かつ途膜の機械的強度に優れた膜形成用組成物(層間絶縁膜用材料)を提供することが可能である。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4J038 DL021 DL031 DL041 DL161

GA01 GA02 GA03 GA06 GA07 GA08 GA12 GA13 JA19 JA20 JA22 JA26 JA27 JA33 JA43 JA56 JB01 JB11 JB13 JB25 JB29 JB30 JC17 KA03 KA06 LA03 MA08 MA10 NA11 NA21

PA19 PB09